

概要

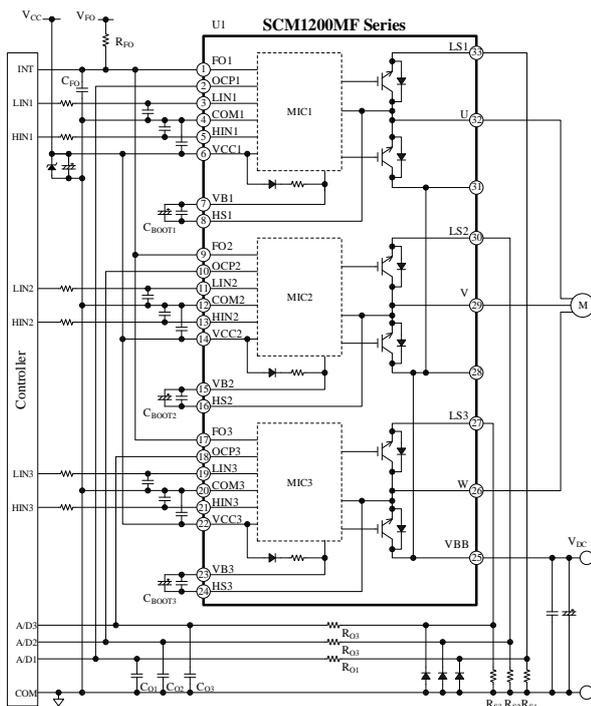
SCM1200MF シリーズは、スイッチング素子、プリドライバおよび制限抵抗付きブートストラップダイオードを 1 パッケージにした、高圧 3 相モータ用ドライバです。

3 ショット方式に対応し、ユニバーサル入力仕様の中容量モータのインバータ制御に最適です。

特長

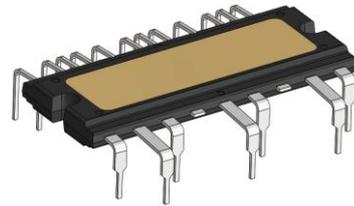
- ハーフブリッジごとにプリドライバを内蔵
- 異常時に全出力素子の遮断が可能
(FO 端子の共通接続)
- ブートストラップダイオード内蔵 (制限抵抗 22 Ω)
- CMOS (3.3 V、5 V 系) 入力レベル対応
- Pb フリー (RoHS 対応)
- 絶縁耐圧 2500V (1 分) 保証
UL 認定済み (File No.: E118037)
- 保護回路動作時エラー信号出力
- 保護機能
電源電圧低下保護機能
ハイサイド (UVLO_VB) : 自動復帰
ローサイド (UVLO_VCC) : 自動復帰
過電流保護機能 (OCP) : 自動復帰
同時オン防止機能 : 自動復帰
サーマルシャットダウン (TSD) : 自動復帰

応用回路例



パッケージ

DIP33 (ピン間隔: 1.27 mm、ボディーサイズ: 47 × 19 × 4.4 mm)



原寸大ではありません。

SCM1200MF シリーズ

- 出力素子: IGBT+FRD (600 V)

電流定格	特長	製品名
10 A	低ノイズ	SCM1261MF*
15 A	低ノイズ	SCM1242MF
		SCM1263MF*
20 A	低ノイズ	SCM1265MF*
30 A	低ノイズ	SCM1256MF

*過電流保護ブランキング時間短縮タイプ

アプリケーション

- 冷蔵庫・エアコンのコンプレッサ駆動
- 洗濯機のドラム駆動
- ファンモータ、ポンプ駆動

目次

概要	1
目次	2
1. 絶対最大定格	4
2. 推奨動作条件	5
3. 電気的特性	6
3.1. 制御部特性	6
3.2. ブートストラップダイオード特性	7
3.3. 熱抵抗	7
3.4. スイッチング素子特性	8
3.4.1. SCM1261MF	8
3.4.2. SCM1242MF	9
3.4.3. SCM1263MF	9
3.4.4. SCM1265MF	10
3.4.5. SCM1256MF	10
4. 機械的特性	11
5. 絶縁距離	11
6. 真理値表	12
7. ブロックダイアグラム	13
8. 各端子機能	14
9. 応用回路例	15
10. 外形図	17
10.1. LF2552	17
10.2. LF2557 (ロングリードタイプ)	18
10.3. PCB 穴径 (参考値)	19
11. 捺印仕様	19
12. 機能説明	20
12.1. 起動、停止時の注意	20
12.2. 各端子の設定	20
12.2.1. U、V、W 端子	20
12.2.2. VBB 端子	20
12.2.3. VB1、VB2、VB3 端子	20
12.2.4. HS1、HS2、HS3 端子	21
12.2.5. VCC1、VCC2、VCC3 端子	21
12.2.6. COM1、COM2、COM3 端子	21
12.2.7. HIN1、HIN2、HIN3 端子 LIN1、LIN2、LIN3 端子	22
12.2.8. LS1、LS2、LS3 端子	22
12.2.9. OCP1、OCP2、OCP3 端子	23
12.2.10. FO1、FO2、FO3 端子	23
12.3. 保護機能	24
12.3.1. エラー出力	24
12.3.2. シャットダウン信号入力	24
12.3.3. 電源電圧低下保護機能 (UVLO)	24
12.3.4. 過電流保護機能(OCP)	25
12.3.5. 同時オン防止機能	26

12.3.6. サーマルシャットダウン (TSD)	26
13. 設計上の注意点	27
13.1. パターンレイアウト	27
13.2. 放熱器を取り付ける際の注意	28
13.3. IC の特性を測定する際の注意	28
14. 損失の計算とジャンクション温度の推定	29
14.1. IGBT の定常損失 P_{ON}	29
14.2. IGBT のスイッチング損失 P_{sw}	29
14.3. IGBT のジャンクション温度の推定	29
15. 代表特性グラフ	30
15.1. 過渡熱抵抗特性グラフ	30
15.1.1. SCM1261MF	30
15.1.2. SCM1242MF、SCM1263MF	30
15.1.3. SCM1265MF	31
15.1.4. SCM1256MF	31
15.2. 制御部代表特性グラフ	32
15.3. 出力特性グラフ	38
15.3.1. 出力素子特性	38
15.3.2. スwitchング損失特性グラフ	40
15.4. 許容実効電流特性グラフ	45
15.4.1. SCM1261MF	45
15.4.2. SCM1242MF、SCM1263MF	46
15.4.3. SCM1265MF	47
15.4.4. SCM1256MF	48
15.5. 短絡 SOA	49
15.5.1. SCM1261MF	49
15.5.2. SCM1242MF、SCM1263MF	49
15.5.3. SCM1265MF	50
15.5.4. SCM1256MF	50
16. パターンレイアウト例	51
17. モータドライバ回路例	53
注意書き	54

SCM1200MF シリーズ

1. 絶対最大定格

電流値の極性は、IC を基準として流入（シンク）を“+”、流出（ソース）を“-”と規定します。
特記がない場合の条件は $T_A = 25\text{ }^\circ\text{C}$ です。

項目	記号	条件	定格	単位	備考
主電源電圧（連続）	V_{DC}	VBB-LSx 間	450	V	
主電源電圧（サージ）	$V_{DC(SURGE)}$	VBB-LSx 間	500	V	
IGBT 出力耐圧	V_{CES}	$V_{CC} = 15\text{ V}$ 、 $I_c = 1\text{ mA}$ 、 $V_{IN} = 0\text{ V}$	600	V	
制御電源電圧	V_{CC}	VCCx-COMx 間	20	V	
	V_{BS}	VBx-HSx 間	20		
出力電流 ⁽¹⁾	I_o	$T_c = 25\text{ }^\circ\text{C}$ 、 $T_j < 150\text{ }^\circ\text{C}$	10	A	SCM1261MF
			15		SCM1242MF/63MF
			20		SCM1265MF
			30		SCM1256MF
出力電流（パルス）	I_{OP}	$T_c = 25\text{ }^\circ\text{C}$ 、 $P_w \leq 1\text{ ms}$ 、 シングルパルス	20	A	SCM1261MF
			30		SCM1242MF/63MF/ 65MF
			45		SCM1256MF
入力電圧	V_{IN}	HINx-COMx 間、 LINx-COMx 間	-0.5~7	V	
FO 端子電圧	V_{FO}	FOx-COMx 間	-0.5~7	V	
OCP 端子電圧	V_{OCP}	OCPx-COMx 間	-10~5	V	
動作ケース温度 ⁽²⁾	$T_{C(OP)}$		-30~100	$^\circ\text{C}$	
ジャンクション温度 ⁽³⁾	T_j		150	$^\circ\text{C}$	
保存温度	T_{STG}		-40~150	$^\circ\text{C}$	
絶縁耐圧 ⁽⁴⁾	$V_{ISO(RMS)}$	裏面-端子間、 AC、60 Hz、1 分間	2500	V	

(1) 実際のケース温度に応じたディレーティングが必要（15.4 項 許容実効電流特性グラフ参照）

(2) IC 動作時のケース温度

(3) IC 内部の各チップ（制御 IC、スイッチング素子、フリーホイールダイオード）のジャンクション温度

(4) すべての端子（ショート）とケース間の絶縁耐圧

SCM1200MF シリーズ

2. 推奨動作条件

項目	記号	条件	Min.	Typ.	Max.	単位	備考
主電源電圧	V_{DC}	COM1 = COM2 = COM3、 VBB-COM 間	—	300	400	V	
制御電源電圧	V_{CC}	VCCx-COMx 間	13.5	—	16.5	V	
	V_{BS}	VBx-HSx 間	13.5	—	16.5	V	
入力電圧 (HINx、LINx、FOX)	V_{IN}		0	—	5.5	V	
最小入力パルス幅	$t_{IN(MIN)ON}$		0.5	—	—	μs	
	$t_{IN(MIN)OFF}$		0.5	—	—	μs	
入力信号デッドタイム	t_{DEAD}		1.5	—	—	μs	
FO 端子プルアップ抵抗	R_{FO}		1	—	22	k Ω	
FO 端子プルアップ電圧	V_{FO}		3.0	—	5.5	V	
FO 端子ノイズ除去用 コンデンサ	C_{FO}		0.001	—	0.01	μF	
ブートストラップコン デンサ	C_{BOOT}		10	—	220	μF	
シャント抵抗	R_S	$I_P \leq 45 A$	12	—	—	m Ω	SCM1256MF
		$I_P \leq 30 A$	18	—	—		SCM1242MF/ 63MF/65MF
		$I_P \leq 20 A$	27	—	—		SCM1261MF
RC フィルタ抵抗	R_O		—	—	100	Ω	
RC フィルタコンデンサ	C_O		1000	—	2200	pF	SCM1242MF SCM1256MF
			1000	—	10000		SCM1260MF
PWM キャリア周波数	f_c		—	—	20	kHz	
動作ケース温度	$T_{C(OP)}$		—	—	100	$^{\circ}C$	

SCM1200MF シリーズ

3. 電気的特性

電流値の極性は、IC を基準として流入（シンク）を“+”、流出（ソース）を“-”と規定します。
特記がない場合の条件は $T_A = 25\text{ }^\circ\text{C}$ 、 $V_{CC} = 15\text{ V}$ です。

3.1. 制御部特性

項目	記号	条件	Min.	Typ.	Max.	単位	備考
電源部							
制御動作開始電圧	$V_{CC(ON)}$	VCCx-COMx 間	10.5	11.5	12.5	V	
	$V_{BS(ON)}$	VBx-HSx 間	10.5	11.5	12.5	V	
制御動作停止電圧	$V_{CC(OFF)}$	VCCx-COMx 間	10.0	11.0	12.0	V	
	$V_{BS(OFF)}$	VBx-HSx 間	10.0	11.0	12.0	V	
制御電源電流	I_{CC}	VCC1 = VCC2 = VCC3、 COM1 = COM2 = COM3、 3 相合計 VCC 端子電流	—	3	—	mA	
	I_{BS}	VB-HS = 15 V、HIN = 5 V、 1 相あたりの VB 端子電流	—	140	—	μA	
入力信号部							
ハイレベル入力しきい電圧 (HINx、LINx、FOx)	V_{IH}		1.5	2.0	2.5	V	
ローレベル入力しきい電圧 (HINx、LINx、FOx)	V_{IL}		1.0	1.5	2.0	V	
ハイレベル入力電流 (HINx、LINx)	I_{IH}	$V_{IN} = 5\text{ V}$	—	230	500	μA	
ローレベル入力電流 (HINx、LINx)	I_{IL}	$V_{IN} = 0\text{ V}$	—	—	2	μA	
エラー信号出力							
エラー信号出力時 FO 端子電圧	V_{FOL}	$V_{FO} = 5\text{ V}$ 、 $R_{FO} = 10\text{ k}\Omega$	—	—	0.5	V	
定常動作時 FO 端子電圧	V_{FOH}	$V_{FO} = 5\text{ V}$ 、 $R_{FO} = 10\text{ k}\Omega$	4.8	—	—	V	
保護機能							
過電流保護動作電圧	V_{TRIP}		0.46	0.50	0.54	V	
過電流保護保持時間	t_p		20	26	—	μs	
過電流保護ブランキング時間	t_{BK}	$V_{TRIP} = 1\text{ V}$	—	1.65	—	μs	SCM1242MF SCM1256MF
			—	0.54	—		SCM1260MF
サーマルシャットダウン動作温度*	T_{DH}		135	150	—	$^\circ\text{C}$	
サーマルシャットダウン動作解除温度*	T_{DL}		105	120	—	$^\circ\text{C}$	

* 制御 IC の温度です。

SCM1200MF シリーズ

3.2. ブートストラップダイオード特性

項目	記号	条件	Min.	Typ.	Max.	単位	備考
ブートストラップダイオードリーク電流	I_{LBD}	$V_R = 600 \text{ V}$	—	—	10	μA	
ブートストラップダイオード順電圧	V_{FB}	$I_{FB} = 0.15 \text{ A}$	—	1.1	1.3	V	
ブートストラップダイオード直列抵抗	R_{BOOT}		17.6	22.0	26.4	Ω	

3.3. 熱抵抗

項目	記号	条件	Min.	Typ.	Max.	単位	備考
ジャンクション-ケース間熱抵抗 ⁽¹⁾	$R_{(J-C)Q}^{(2)}$	IGBT 1 素子あたり	—	—	3.7	$^{\circ}\text{C/W}$	SCM1261MF
			—	—	3		SCM12/42MF/ 63MF/65MF/56MF
	$R_{(J-C)F}^{(3)}$	フリーホイールダイオード 1 素子あたり	—	—	4.5	$^{\circ}\text{C/W}$	SCM1261MF
			—	—	4		SCM12/42MF/ 63MF/65MF/56MF

(1) ケース温度は図 3-1 で規定

(2) 内部スイッチング素子のジャンクションとケース間の定常熱抵抗（過渡熱特性は 15.1 項を参照）

(3) 内部フリーホイールダイオードのジャンクションとケース間の定常熱抵抗

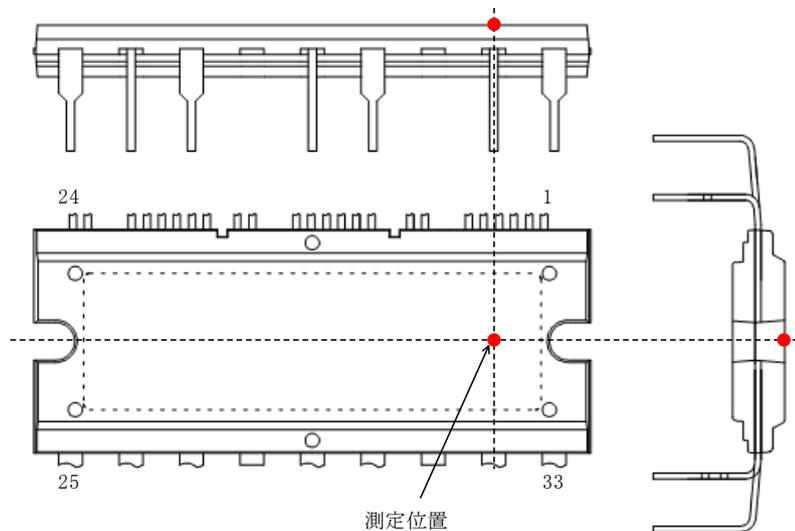


図 3-1 ケース温度測定位置

3.4. スイッチング素子特性

本項に示すスイッチング特性の定義は図 3-2 のとおりです。

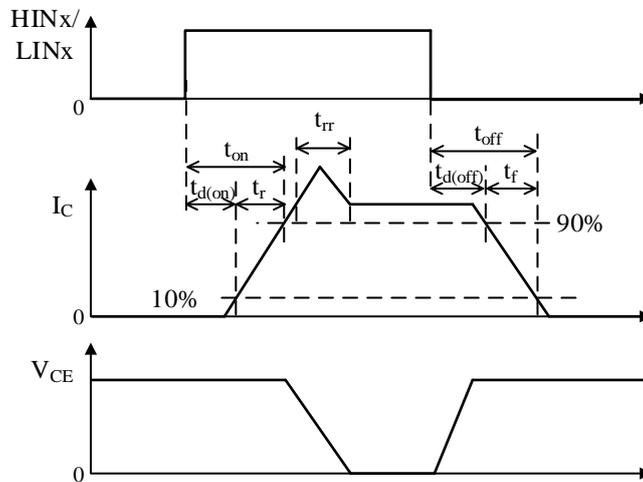


図 3-2 スイッチング時間の定義

3.4.1. SCM1261MF

項目	記号	条件	Min.	Typ.	Max.	単位
コレクター-エミッタ間漏れ電流	I_{CES}	$V_{CE} = 600 \text{ V}$ 、 $V_{IN} = 0 \text{ V}$	—	—	1	mA
コレクター-エミッタ間飽和電圧	$V_{CE(SAT)}$	$I_C = 10 \text{ A}$ 、 $V_{IN} = 5 \text{ V}$	—	1.7	2.2	V
ダイオード順電圧	V_F	$I_F = 10 \text{ A}$ 、 $V_{IN} = 0 \text{ V}$	—	1.7	2.2	V
ハイサイドスイッチング特性						
ダイオード逆回復時間	t_{rr}	$V_{DC} = 300 \text{ V}$ 、 $I_C = 10 \text{ A}$ 、 $V_{IN} = 0 \leftrightarrow 5 \text{ V}$ 、 $T_J = 25 \text{ }^\circ\text{C}$ 、 誘導負荷	—	85	—	ns
ターンオン遅延時間	$t_{d(on)}$		—	700	—	ns
上昇時間	t_r		—	100	—	ns
ターンオフ遅延時間	$t_{d(off)}$		—	1070	—	ns
下降時間	t_f		—	90	—	ns
ローサイドスイッチング特性						
ダイオード逆回復時間	t_{rr}	$V_{DC} = 300 \text{ V}$ 、 $I_C = 10 \text{ A}$ 、 $V_{IN} = 0 \leftrightarrow 5 \text{ V}$ 、 $T_J = 25 \text{ }^\circ\text{C}$ 、 誘導負荷	—	105	—	ns
ターンオン遅延時間	$t_{d(on)}$		—	710	—	ns
上昇時間	t_r		—	120	—	ns
ターンオフ遅延時間	$t_{d(off)}$		—	1010	—	ns
下降時間	t_f		—	95	—	ns

SCM1200MF シリーズ

3.4.2. SCM1242MF

項目	記号	条件	Min.	Typ.	Max.	単位
コレクタ-エミッタ間漏れ電流	I_{CES}	$V_{CE} = 600 \text{ V}$ 、 $V_{IN} = 0 \text{ V}$	—	—	1	mA
コレクタ-エミッタ間飽和電圧	$V_{CE(SAT)}$	$I_C = 15 \text{ A}$ 、 $V_{IN} = 5 \text{ V}$	—	1.7	2.2	V
ダイオード順電圧	V_F	$I_F = 15 \text{ A}$ 、 $V_{IN} = 0 \text{ V}$	—	1.75	2.2	V
ハイサイドスイッチング特性						
ダイオード逆回復時間	t_{rr}	$V_{DC} = 300 \text{ V}$ 、 $I_C = 15 \text{ A}$ 、 $V_{IN} = 0 \leftrightarrow 5 \text{ V}$ 、 $T_J = 25 \text{ }^\circ\text{C}$ 、 誘導負荷	—	80	—	ns
ターンオン遅延時間	$t_{d(on)}$		—	700	—	ns
上昇時間	t_r		—	100	—	ns
ターンオフ遅延時間	$t_{d(off)}$		—	1300	—	ns
下降時間	t_f		—	90	—	ns
ローサイドスイッチング特性						
ダイオード逆回復時間	t_{rr}	$V_{DC} = 300 \text{ V}$ 、 $I_C = 15 \text{ A}$ 、 $V_{IN} = 0 \leftrightarrow 5 \text{ V}$ 、 $T_J = 25 \text{ }^\circ\text{C}$ 、 誘導負荷	—	90	—	ns
ターンオン遅延時間	$t_{d(on)}$		—	700	—	ns
上昇時間	t_r		—	130	—	ns
ターンオフ遅延時間	$t_{d(off)}$		—	1230	—	ns
下降時間	t_f		—	90	—	ns

3.4.3. SCM1263MF

項目	記号	条件	Min.	Typ.	Max.	単位
コレクタ-エミッタ間漏れ電流	I_{CES}	$V_{CE} = 600 \text{ V}$ 、 $V_{IN} = 0 \text{ V}$	—	—	1	mA
コレクタ-エミッタ間飽和電圧	$V_{CE(SAT)}$	$I_C = 15 \text{ A}$ 、 $V_{IN} = 5 \text{ V}$	—	1.7	2.2	V
ダイオード順電圧	V_F	$I_F = 15 \text{ A}$ 、 $V_{IN} = 0 \text{ V}$	—	1.75	2.2	V
ハイサイドスイッチング特性						
ダイオード逆回復時間	t_{rr}	$V_{DC} = 300 \text{ V}$ 、 $I_C = 15 \text{ A}$ 、 $V_{IN} = 0 \leftrightarrow 5 \text{ V}$ 、 $T_J = 25 \text{ }^\circ\text{C}$ 、 誘導負荷	—	80	—	ns
ターンオン遅延時間	$t_{d(on)}$		—	700	—	ns
上昇時間	t_r		—	100	—	ns
ターンオフ遅延時間	$t_{d(off)}$		—	1300	—	ns
下降時間	t_f		—	90	—	ns
ローサイドスイッチング特性						
ダイオード逆回復時間	t_{rr}	$V_{DC} = 300 \text{ V}$ 、 $I_C = 15 \text{ A}$ 、 $V_{IN} = 0 \leftrightarrow 5 \text{ V}$ 、 $T_J = 25 \text{ }^\circ\text{C}$ 、 誘導負荷	—	90	—	ns
ターンオン遅延時間	$t_{d(on)}$		—	700	—	ns
上昇時間	t_r		—	130	—	ns
ターンオフ遅延時間	$t_{d(off)}$		—	1230	—	ns
下降時間	t_f		—	90	—	ns

SCM1200MF シリーズ

3.4.4. SCM1265MF

項目	記号	条件	Min.	Typ.	Max.	単位
コレクタ-エミッタ間漏れ電流	I_{CES}	$V_{CE} = 600 \text{ V}$ 、 $V_{IN} = 0 \text{ V}$	—	—	1	mA
コレクタ-エミッタ間飽和電圧	$V_{CE(SAT)}$	$I_C = 20 \text{ A}$ 、 $V_{IN} = 5 \text{ V}$	—	1.7	2.2	V
ダイオード順電圧	V_F	$I_F = 20 \text{ A}$ 、 $V_{IN} = 0 \text{ V}$	—	1.9	2.4	V
ハイサイドスイッチング特性						
ダイオード逆回復時間	t_{rr}	$V_{DC} = 300 \text{ V}$ 、 $I_C = 20 \text{ A}$ 、 $V_{IN} = 0 \leftrightarrow 5 \text{ V}$ 、 $T_J = 25 \text{ }^\circ\text{C}$ 、 誘導負荷	—	80	—	ns
ターンオン遅延時間	$t_{d(on)}$		—	780	—	ns
上昇時間	t_r		—	120	—	ns
ターンオフ遅延時間	$t_{d(off)}$		—	1150	—	ns
下降時間	t_f		—	90	—	ns
ローサイドスイッチング特性						
ダイオード逆回復時間	t_{rr}	$V_{DC} = 300 \text{ V}$ 、 $I_C = 20 \text{ A}$ 、 $V_{IN} = 0 \leftrightarrow 5 \text{ V}$ 、 $T_J = 25 \text{ }^\circ\text{C}$ 、 誘導負荷	—	85	—	ns
ターンオン遅延時間	$t_{d(on)}$		—	810	—	ns
上昇時間	t_r		—	170	—	ns
ターンオフ遅延時間	$t_{d(off)}$		—	1100	—	ns
下降時間	t_f		—	90	—	ns

3.4.5. SCM1256MF

項目	記号	条件	Min.	Typ.	Max.	単位
コレクタ-エミッタ間漏れ電流	I_{CES}	$V_{CE} = 600 \text{ V}$ 、 $V_{IN} = 0 \text{ V}$	—	—	1	mA
コレクタ-エミッタ間飽和電圧	$V_{CE(SAT)}$	$I_C = 30 \text{ A}$ 、 $V_{IN} = 5 \text{ V}$	—	1.7	2.2	V
ダイオード順電圧	V_F	$I_F = 30 \text{ A}$ 、 $V_{IN} = 0 \text{ V}$	—	1.9	2.4	V
ハイサイドスイッチング特性						
ダイオード逆回復時間	t_{rr}	$V_{DC} = 300 \text{ V}$ 、 $I_C = 30 \text{ A}$ 、 $V_{IN} = 0 \leftrightarrow 5 \text{ V}$ 、 $T_J = 25 \text{ }^\circ\text{C}$ 、 誘導負荷	—	70	—	ns
ターンオン遅延時間	$t_{d(on)}$		—	760	—	ns
上昇時間	t_r		—	130	—	ns
ターンオフ遅延時間	$t_{d(off)}$		—	1260	—	ns
下降時間	t_f		—	90	—	ns
ローサイドスイッチング特性						
ダイオード逆回復時間	t_{rr}	$V_{DC} = 300 \text{ V}$ 、 $I_C = 30 \text{ A}$ 、 $V_{IN} = 0 \leftrightarrow 5 \text{ V}$ 、 $T_J = 25 \text{ }^\circ\text{C}$ 、 誘導負荷	—	80	—	ns
ターンオン遅延時間	$t_{d(on)}$		—	770	—	ns
上昇時間	t_r		—	160	—	ns
ターンオフ遅延時間	$t_{d(off)}$		—	1200	—	ns
下降時間	t_f		—	90	—	ns

SCM1200MF シリーズ

4. 機械的特性

項目	条件	Min.	Typ.	Max.	単位	備考
締付けトルク	*	0.588	—	0.784	N・m	
放熱面平坦度	図 4-1 参照	0	—	200	μm	
質量		—	11.8	—	g	

* 取り付けネジは M3、平座金は φ7 を推奨します。締付けの際の注意事項は、13.2 項を参照してください。

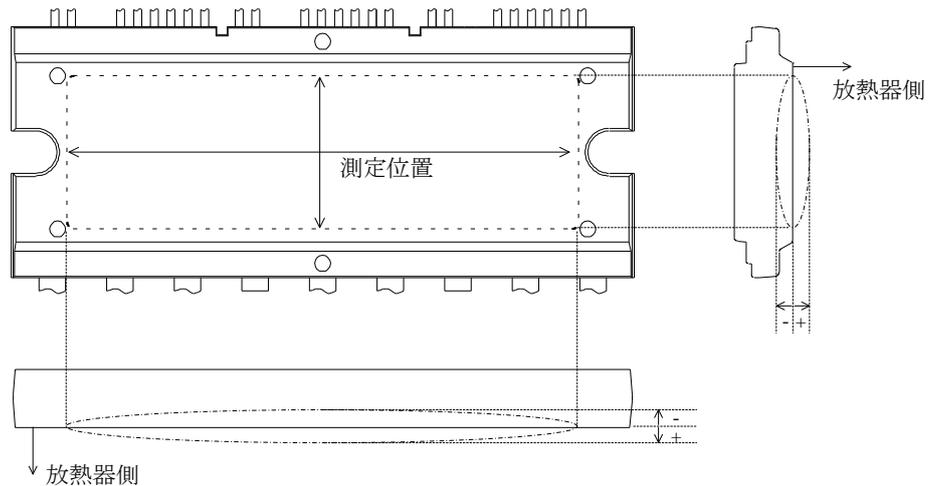


図 4-1 放熱面平坦度測定位置

5. 絶縁距離

項目	条件	Min.	Typ.	Max.	単位	備考
空間距離	放熱器*~リード間	2.0	—	2.5	mm	
沿面距離	図 5-1 参照	3.86	—	4.26	mm	

* 放熱器の形状が平坦の場合です。本規格値以上の空間距離を確保する場合は、放熱器の形状を凸にするなどの対応が必要です。

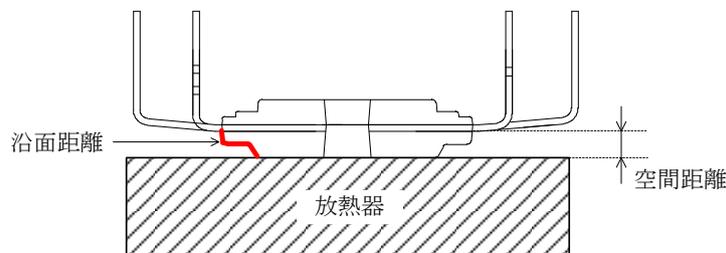


図 5-1 絶縁距離測定位置

6. 真理値表

表 6-1 に各動作モードの真理値表を示します。

各相において、HINx と LINx に“H”を入力した場合、同時オン防止機能が動作し、出力スイッチング素子はハイサイド、ローサイド共にオフになります。

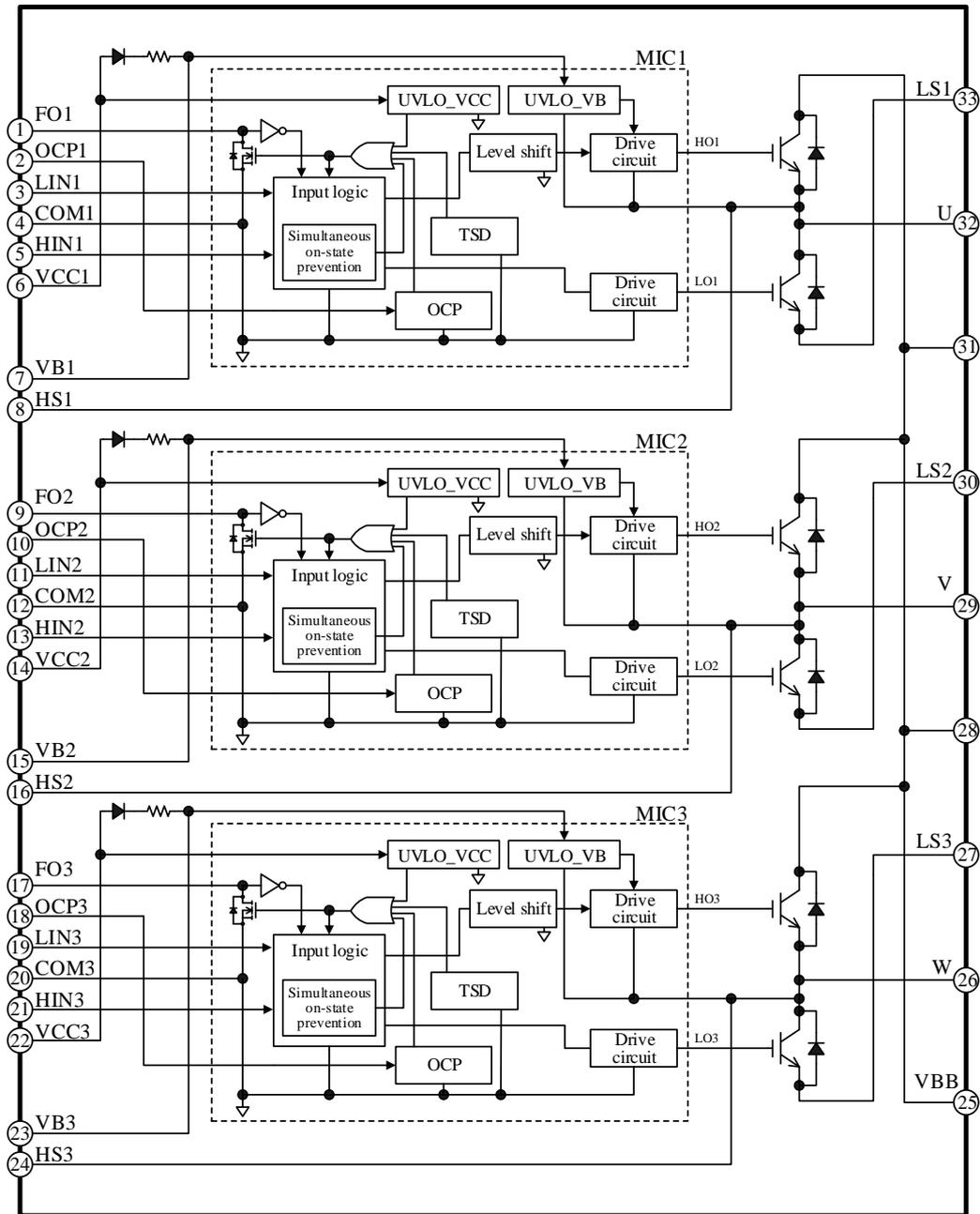
ローサイド電源電圧低下保護 (UVLO_VCC) から復帰した後は、ハイサイドとローサイドの出力スイッチング素子は入力論理に応じてオン/オフします (レベル動作)。

ハイサイド電源電圧低下保護動作 (UVLO_VB) から復帰した後は、次の立ち上がりエッジからハイサイドの出力スイッチング素子をオン/オフします (エッジ動作)。

表 6-1 各動作モードの真理値表

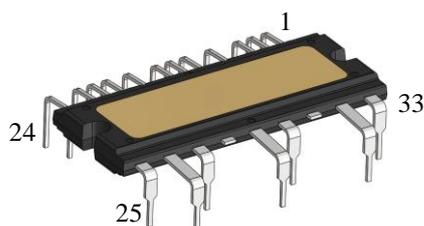
モード	HINx	LINx	ハイサイドスイッチ	ローサイドスイッチ
定常動作	L	L	OFF	OFF
	H	L	ON	OFF
	L	H	OFF	ON
	H	H	OFF	OFF
外部シャットダウン信号入力 FO=L	L	L	OFF	OFF
	H	L	OFF	OFF
	L	H	OFF	OFF
	H	H	OFF	OFF
ハイサイド電源電圧低下 保護動作(UVLO_VB)	L	L	OFF	OFF
	H	L	OFF	OFF
	L	H	OFF	ON
	H	H	OFF	OFF
ローサイド電源電圧低下 保護動作(UVLO_VCC)	L	L	OFF	OFF
	H	L	OFF	OFF
	L	H	OFF	OFF
	H	H	OFF	OFF
過電流保護動作(OCP)	L	L	OFF	OFF
	H	L	OFF	OFF
	L	H	OFF	OFF
	H	H	OFF	OFF
サーマルシャットダウン動作 (TSD)	L	L	OFF	OFF
	H	L	OFF	OFF
	L	H	OFF	OFF
	H	H	OFF	OFF

7. ブロックダイアグラム

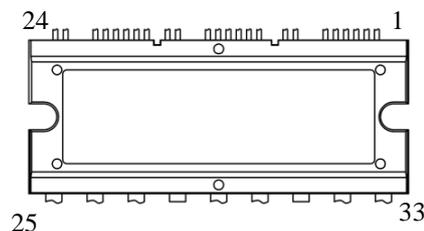


SCM1200MF シリーズ

8. 各端子機能



上面図



端子番号	端子名	機能
1	FO1	U相エラー出力/シャットダウン信号入力
2	OCP1	U相過電流保護信号入力
3	LIN1	U相ローサイド制御信号入力
4	COM1	U相制御グランド
5	HIN1	U相ハイサイド制御信号入力
6	VCC1	U相制御回路電源入力
7	VB1	U相ハイサイド・フローティング電源入力
8	HS1	U相ハイサイド・フローティング電源グランド
9	FO2	V相エラー出力/シャットダウン信号入力
10	OCP2	V相過電流保護信号入力
11	LIN2	V相ローサイド制御信号入力
12	COM2	V相制御グランド
13	HIN2	V相ハイサイド制御信号入力
14	VCC2	V相制御回路電源入力
15	VB2	V相ハイサイド・フローティング電源入力
16	HS2	V相ハイサイド・フローティング電源グランド
17	FO3	W相エラー出力/シャットダウン信号入力
18	OCP3	W相過電流保護信号入力
19	LIN3	W相ローサイド制御信号入力
20	COM3	W相制御グランド
21	HIN3	W相ハイサイド制御信号入力
22	VCC3	W相制御回路電源入力
23	VB3	W相ハイサイド・フローティング電源入力
24	HS3	W相ハイサイド・フローティング電源グランド
25	VBB	DC(+)電源入力
26	W	W相出力
27	LS3	W相 IGBT エミッタ
28	VBB	DC(+)電源入力 (カットピン)
29	V	V相出力
30	LS2	V相 IGBT エミッタ
31	VBB	DC(+)電源入力 (カットピン)
32	U	U相出力
33	LS1	U相 IGBT エミッタ

9. 応用回路例

各端子へのサージ印加は、IC の誤動作の原因や、絶対最大定格を超えると IC の破壊の原因になります。そのため、必要に応じて CR フィルタ回路やツェナーダイオードなどを各端子に追加し、問題がないか実働で確認をしてください。

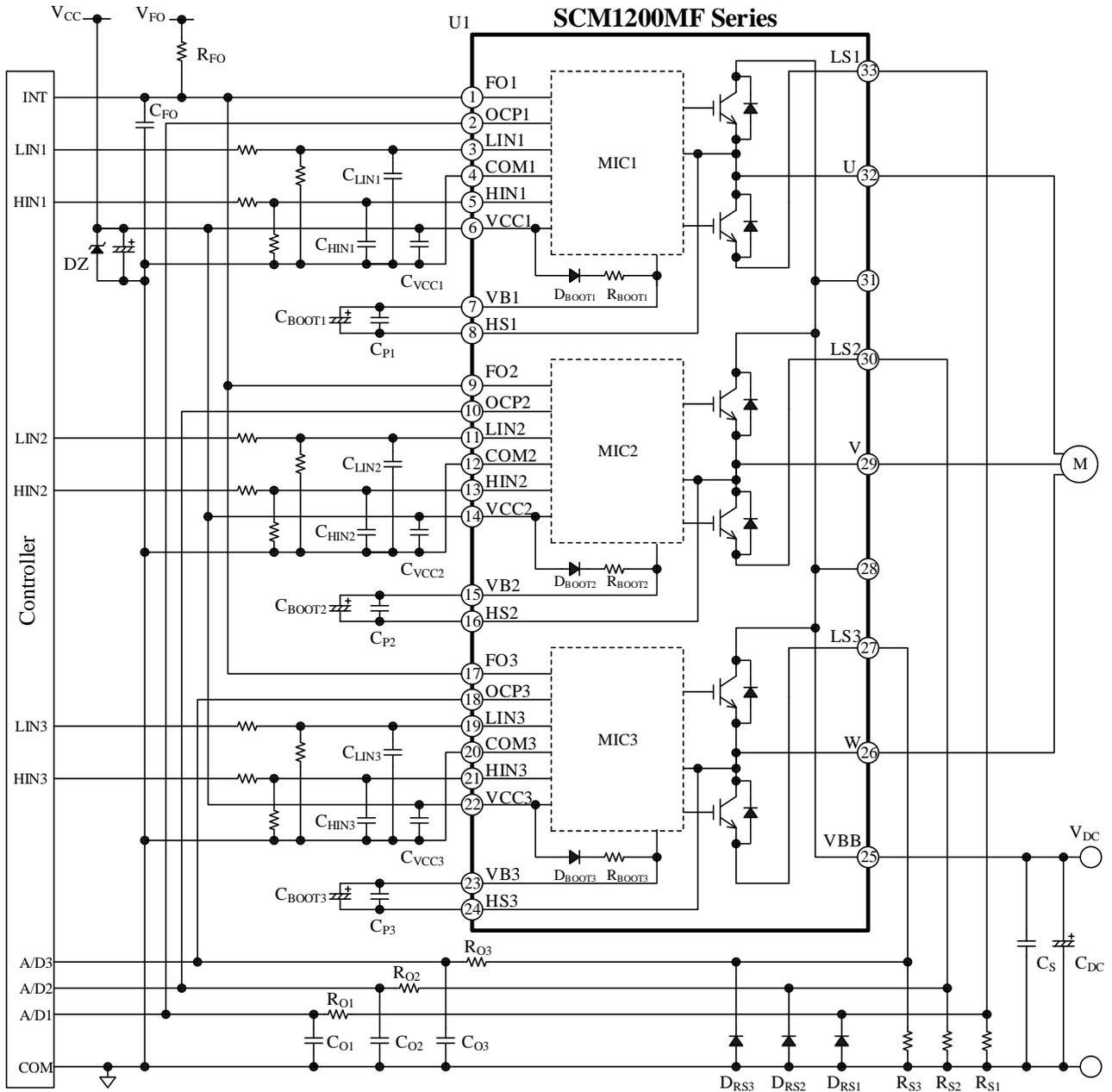


図 9-1 応用回路例 (3 シャント検出方式)

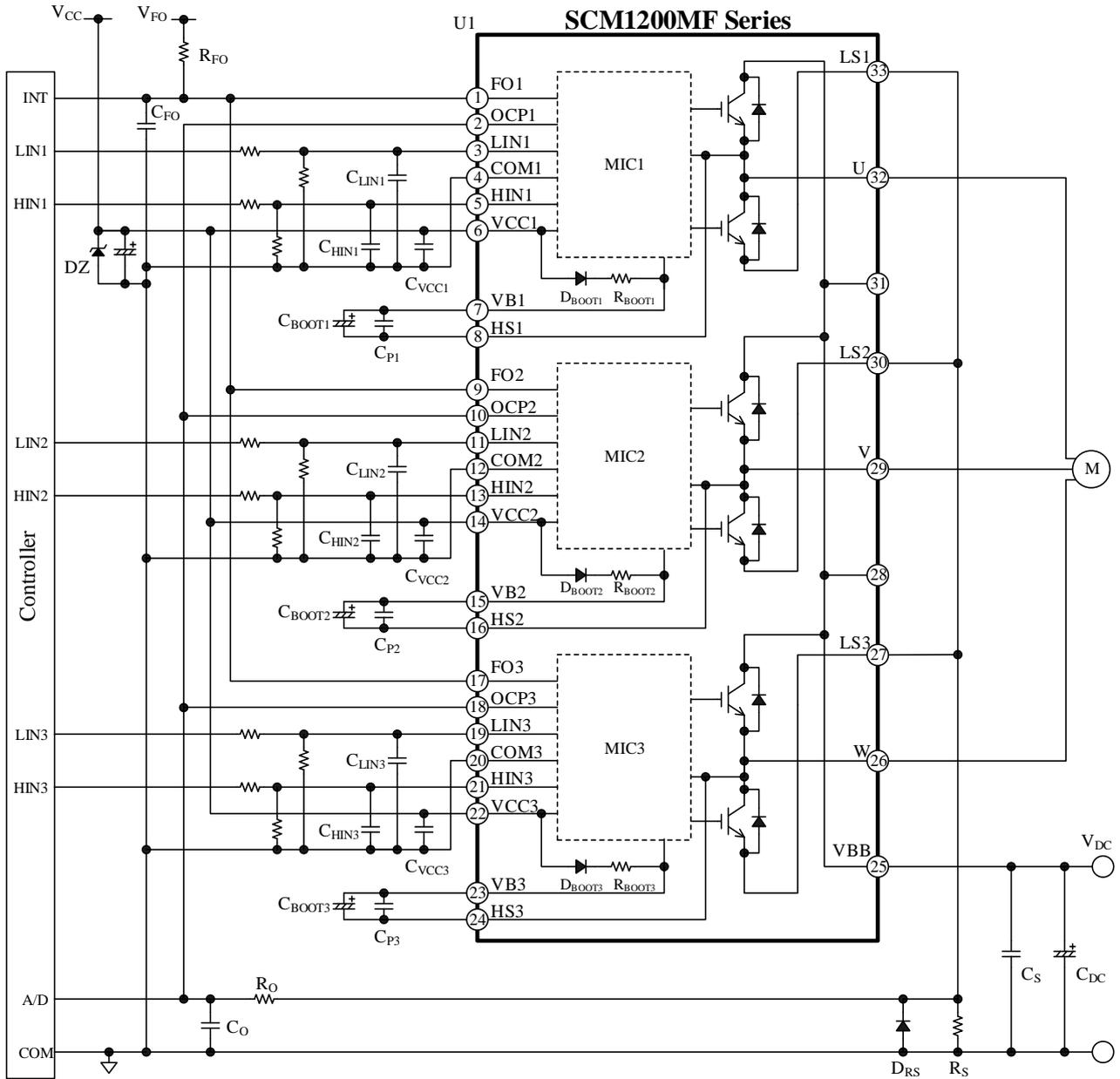
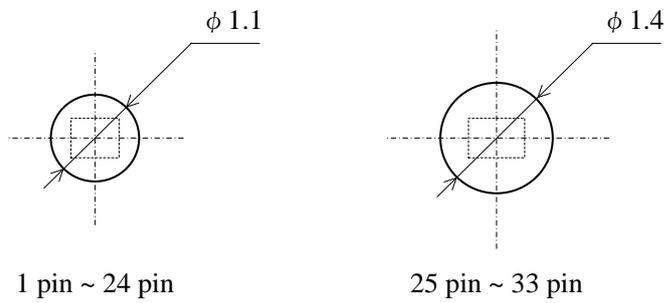
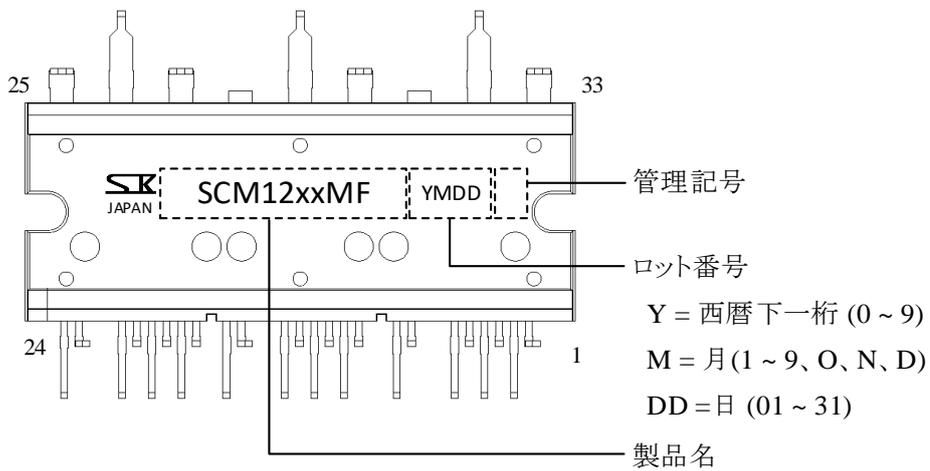
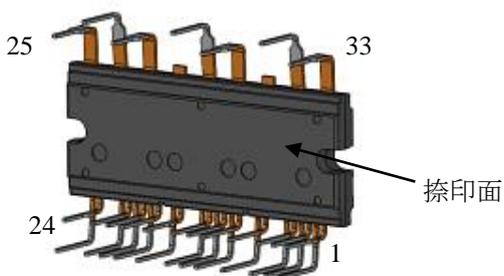


図 9-2 応用回路例 (1 シャント検出方式)

10.3. PCB 穴径 (参考値)



11. 捺印仕様



12. 機能説明

特記のない場合の特性数値は Typ. 値を表記します。

本 IC は U、V、W 相に対応する端子記号に数字 (1~3) が付与されています。本項では、1~3 のいずれか、またはすべての端子を指す場合に、任意の記号“x”を用います。たとえば、“VBx 端子”は VB1 端子、VB2 端子、VB3 端子を指します。また、“VBx 端子と HSx 端子”のように、2 つ以上の端子について述べる場合は“VB1 端子と HS1 端子”のように同相の端子を意味します。

12.1. 起動、停止時の注意

電源の起動時は、本 IC の VCCx 端子電圧が制御電源開始電圧 $V_{CC(ON)}$ の最大値 12.5 V 以上になってから、VBB、HINx、LINx 端子への電圧印加を推奨します。起動時は、ブートストラップ回路用コンデンサ C_{BOOTx} を十分に充電してください (12.2.2 項参照)。

また電源の停止時は、IC への制御信号をすべて“L”にしてから、本 IC の VCCx 端子電圧を下げてください。

12.2. 各端子の設定

12.2.1. U、V、W 端子

U 相、V 相、W 相の出力端子で、モータに接続します。U、V、W 端子は、IC 内部でそれぞれ HS1、HS2、HS3 端子に接続しています。

12.2.2. VBB 端子

DC(+)電源入力端子です。全相のハイサイドの IGBT コレクタに接続されています。VBB 端子と COMx 端子間に印加する電圧は、主電源電圧 V_{DC} (2 項 推奨動作条件参照) を満たすように設定します。

VBB 端子には、サージ電圧を抑えるためコンデンサ C_s (0.01 μ F~0.1 μ F) を接続します。 C_s は平滑用電解コンデンサ C_{DC} と VBB 端子のできるだけ近くに配置し、VBB 端子に最短で接続します。

12.2.3. VB1、VB2、VB3 端子

ハイサイド・フローティング電源の入力端子です。各相の VBx 端子と HSx 端子間に印加する電圧は、推奨制御電源電圧 V_{BS} (2 項 推奨動作条件参照) を

満たすようにします。

ブートストラップ回路用コンデンサ C_{BOOTx} を各相の VBx 端子と HSx 端子の間にそれぞれ接続します。

起動時は、ローサイドのパワー素子をオンして C_{BOOTx} を十分に充電します。 C_{BOOTx} の値は、式(1)と式(2)を満たす値から選定します。このとき、静電容量の許容誤差や DC バイアス特性を十分に考慮する必要があります。

$$C_{BOOTx} (\mu\text{F}) > 800 \times t_{L(OFF)} (\text{s}) \quad (1)$$

$$10 \mu\text{F} \leq C_{BOOTx} \leq 220 \mu\text{F} \quad (2)$$

ここで、

$t_{L(OFF)}$: ローサイドパワー素子の最長オフ時間(s) (C_{BOOTx} を充電しない時間)

ハイサイドのスイッチング動作が停止しているときも、 C_{BOOTx} の電圧は IC の電力消費で低下します。VBx 端子の電圧が制御動作停止電圧 $V_{BS(OFF)}$ 以下に低下すると、ハイサイドの電源電圧低下保護回路 (UVLO_VB) が動作します(12.3.3.1 項参照)。最終的に実働動作で、起動時などの低周波数動作時も VBx 端子電圧が $V_{BS(OFF)}$ の最大値 12.0 V より高い電圧を維持しているか確認が必要です。

図 12-1 のように SCM1200MF シリーズは、VCCx 端子と VBx 端子の間にブートストラップダイオード D_{BOOTx} と突入電流制限用抵抗 R_{BOOTx} を直列に内蔵しています。 C_{BOOTx} 充電時の時定数 τ は式(3)で算出できます。

$$\tau = C_{BOOTx} \times R_{BOOTx} \quad (3)$$

ここで、

C_{BOOTx} : 調整した C_{BOOTx} の値

R_{BOOTx} : 22 $\Omega \pm 20\%$

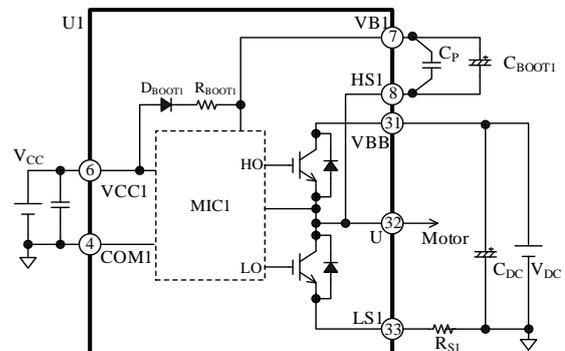


図 12-1 ブートストラップ回路

図 12-2 に IC 内部のレベルシフト部の回路を示します。ハイサイドの出力信号 HO_x は HIN_x 端子の入力信号に応じて生成されます。 HIN_x 端子の信号のアップエッジからセット信号、ダウンエッジからリセット信号が生成され、それぞれレベルシフト回路でハイサイドに伝達されます。それぞれの信号が RS フリップフロップ回路に入力され、 Q (HO_x) が出力されます。

図 12-3 のようにノイズなどの影響で VB_x 端子と HS_x 端子間 (VB_x - HS_x 間) の電圧が急変し、セット信号伝達後に、リセット信号だけがハイサイドに伝達されない場合、ハイサイドのスイッチング素子はオン固定になります。次の LIN_x 信号でローサイドのスイッチング素子がオンすると同時オン状態となり、IC が破壊する可能性があります。

そこで、 VB_x 端子がノイズの影響を受けないように、 C_{BOOTx} は必ず IC の近くに配置し、できるだけ短いパターンで VB_x - HS_x 間に接続します。

電解コンデンサを使用する場合は、バイパスコンデンサ C_{Px} ($0.01 \mu F \sim 0.1 \mu F$) を並列挿入し、各端子にできるだけ短いパターンで接続します。

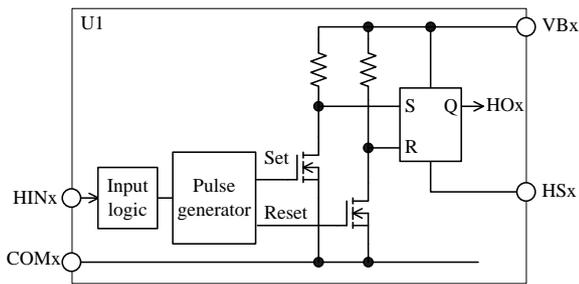


図 12-2 レベルシフト部回路図

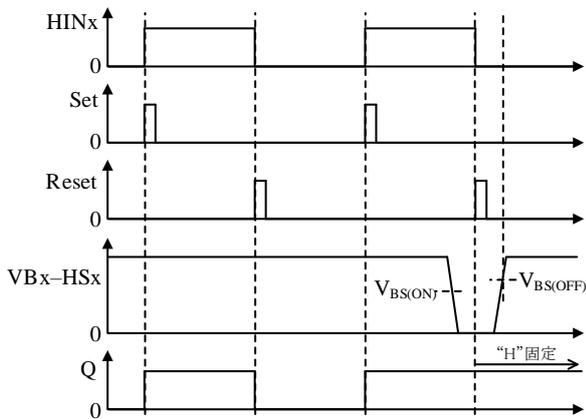


図 12-3 VB_x - HS_x 間電圧低下による誤動作波形

12.2.4. HS1、HS2、HS3 端子

各相のハイサイド・フローティング電源グラウンドです。ブートストラップコンデンサ C_{BOOTx} のマイナス側を接続します。 $HS1$ 、 $HS2$ 、 $HS3$ 端子は、IC 内部でそれぞれ U、V、W 端子に接続しています。

12.2.5. VCC1、VCC2、VCC3 端子

IC の制御回路電源入力端子です。 $VCC1$ 、 $VCC2$ 、 $VCC3$ 端子は IC 内部では接続していないので、基板のパターンで接続します。電源リップルなどによる誤動作を防止するため、各端子にできるだけ短いパターンでコンデンサ C_{VCCx} ($0.01 \mu F \sim 0.1 \mu F$) を接続します。また、サージ電圧による破壊を防止するため $VCCx$ 端子と $COMx$ 端子間にツェナーダイオード DZ ($18V \sim 20V$) を接続します。

各相の $VCCx$ 端子と $COMx$ 端子間に印加する電圧は、推奨制御電源電圧 V_{CC} (2 項 推奨動作条件参照) を満たすように設定します。

12.2.6. COM1、COM2、COM3 端子

IC の制御グラウンド端子です。各相の制御部品はそれぞれのグラウンド端子に接続します。 $COM1$ 、 $COM2$ 、 $COM3$ 端子は IC 内部では接続していないので、基板のパターンで接続します。制御グラウンドの電位が変動すると IC の誤動作の原因となるため、制御グラウンドの配線はパワーグラウンドと分けて、シャント抵抗 R_{Sx} のできるだけ近くに 1 点で、かつできるだけ短く接続します (図 12-4 参照)。このとき、パワー系の電流の影響を受けないように配線には十分に配慮します。

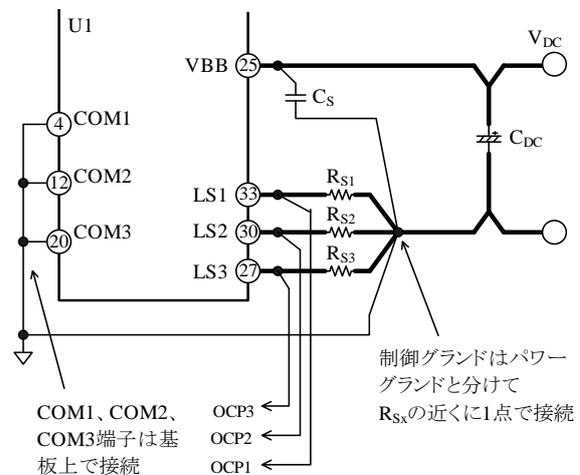


図 12-4 制御グラウンドの配線

12.2.7. HIN1、HIN2、HIN3 端子
LIN1、LIN2、LIN3 端子

モータ制御用の各相入力端子です。HIN_x 端子はハイサイドの制御信号入力、LIN_x 端子はローサイドの制御信号入力です。図 12-5 に HIN_x 端子、LIN_x 端子の内部回路図を示します。22 kΩ のプルダウン抵抗を内蔵し、CMOS シュミットトリガ回路で構成しています。入力論理はアクティブハイです。

各相の HIN_x 端子と COM_x 端子間、LIN_x 端子と COM_x 端子間に印加する信号は表 12-1 の範囲に設定します。本 IC にはデッドタイム生成回路はありません。HIN_x、LIN_x の入力信号は必ずデッドタイムの設定が必要です。

周波数が高くなるとスイッチング損失が増加するため、動作時のケース温度およびジャンクション温度が、1 項 絶対最大定格の値に対し十分に余裕のある値になるよう、周波数を設定する必要があります。

マイコンからの入力信号が不定になると、IC が誤動作する可能性があるため、マイコンの出力はハイインピーダンスにならないように設定してください。また、マイコンから HIN_x、LIN_x 端子までの配線が長くノイズの影響を受けやすい場合は、図 12-6 のように入力フィルタやプルダウン抵抗を HIN_x、LIN_x 端子の近くに追加します。

フィルタの定数の目安は以下のとおりです。

- R_{IN1x} : 33 Ω~100 Ω
- R_{IN2x} : 1 kΩ~10 kΩ
- C_{INx} : 100 pF~1000 pF

R_{IN1x}、R_{IN2x} を接続すると、HIN_x、LIN_x 端子の入力電圧がマイコンの出力電圧より少し低くなるため注意が必要です。

表 12-1 HIN_x、LIN_x 端子入力信号

項目	“H”レベル信号	“L”レベル信号
入力電圧	3 V < V _{IN} < 5.5 V	0 V < V _{IN} < 0.5 V
入力パルス幅	≥0.5 μs	≥0.5 μs
キャリア周波数	≤20 kHz	
デッドタイム	≥1.5 μs	

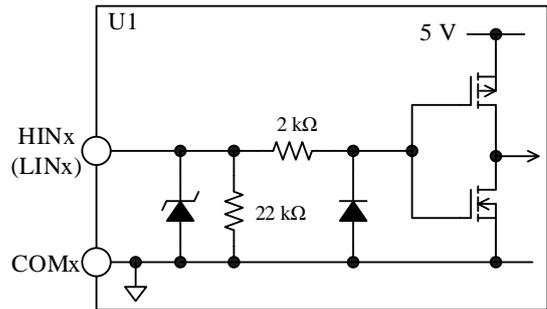


図 12-5 HIN_x 端子、LIN_x 端子の内部回路図

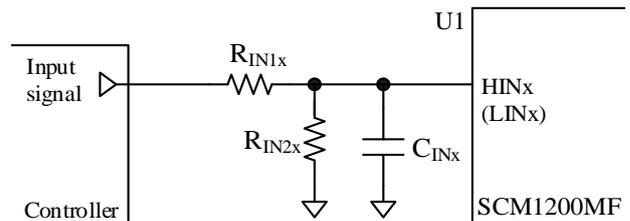


図 12-6 HIN_x 端子、LIN_x 端子のフィルタ回路

12.2.8. LS1、LS2、LS3 端子

各相の IGBT エミッタ端子です。電流検出用のシャント抵抗 R_{Sx} を接続します。

R_{Sx} は IC のできるだけ近くに配置し、LS_x 端子と COM_x 端子に最短で接続します。配線のインダクタンス成分は誤動作の要因になるため、インダクタンス成分が極力小さくなるようにパターンを設計します。この配線が長い場合は、誤動作を防止するため LS_x 端子と COM_x 端子間に高速整流ダイオード D_{RSx} を接続します。

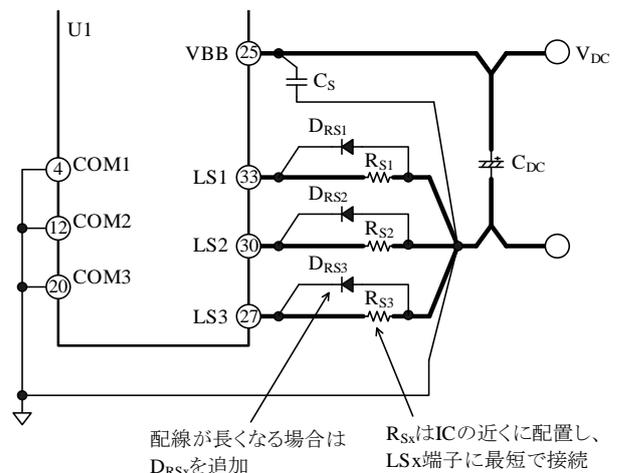


図 12-7 LS_x 端子周りの配線

12.2.9. OCP1、OCP2、OCP3 端子

出力スイッチング素子に流れる電流の過電流保護信号を入力する端子です。

OCPx 端子の周辺部品の設定および、過電流保護機能(OCP)の詳細は 12.3.4 項を参照してください。

12.2.10. FO1、FO2、FO3 端子

各相のエラー出力および、シャットダウン信号の入力端子です。機能の詳細は 12.3.1 項と 12.3.2 項を参照してください。

図 12-8 に FOx 端子の周辺回路と内部回路を示します。FOx 端子はオープンドレインになっているため、プルアップ抵抗 R_{FO} で外部電源に接続します。

外部電源の電圧 V_{FO} は、3.0V~5.5V を接続します。

エラー信号出力時の FOx 端子電圧とプルアップ抵抗 R_{FO} は、図 12-10 の関係があります。R_{FO} の値が小さすぎると図 12-8 の Q_{FO} のオン抵抗によりエラー信号出力時の FOx 端子電圧が高くなります。マイコンのローレベル入力しきい電圧を V_{IL} = 1.0V とした場合、R_{FO} は 1 kΩ~22 kΩ を推奨します。

また、ノイズ除去用コンデンサ C_{FO} は IC のできるだけ近くに配置し、FOx 端子と COMx 端子の間に最短で接続します。

C_{FO} を接続すると、図 12-9 のように遅延時間 t_{D(FO)} が発生します。

t_{D(FO)} は、IC がエラーを検出して Q_{FO} がオンしてから、FOx 端子電圧が V_{IL} = 1.0V になるまで(マイコンが“L”を検出するまで)の時間です。t_{D(FO)} と C_{FO} の関係を図 12-11 に示します。過電流保護機能(OCP)が動作した場合、繰り返しの OCP 動作を避けるため、マイコンは Q_{FO} がオンしてから t_p = 15 μs (温度特性を含む最小値)以内に IC への入力信号を停止する必要があります(詳細は 12.3.4 項参照)。

マイコンのローレベル入力しきい電圧を V_{IL} = 1.0V とした場合、C_{FO} の値は、ばらつきなども考慮し 0.001μF~0.01μF を推奨します。

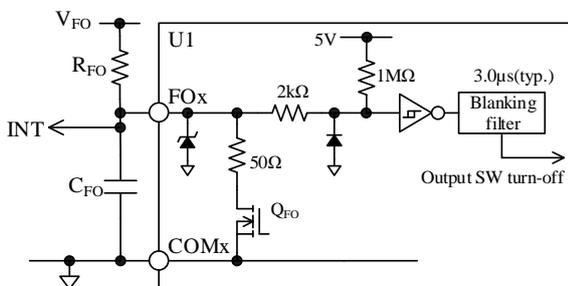


図 12-8 FOx 端子の周辺回路と内部回路

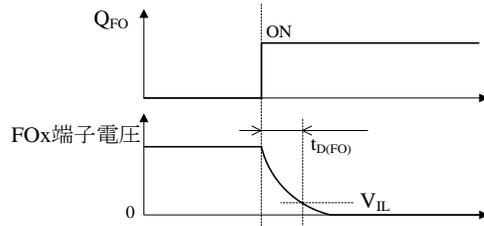


図 12-9 FOx 端子の遅延時間 t_{D(FO)}

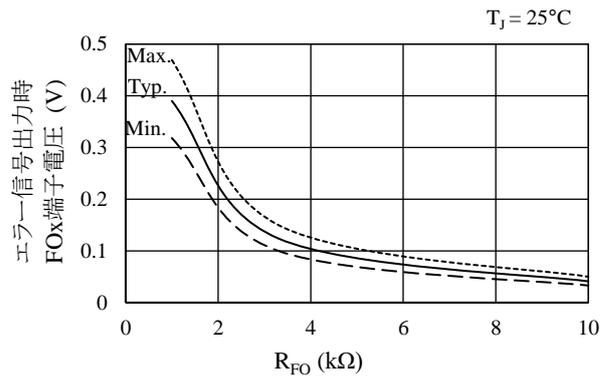


図 12-10 エラー信号出力時 FOx 端子電圧 - プルアップ抵抗 R_{FO} 特性

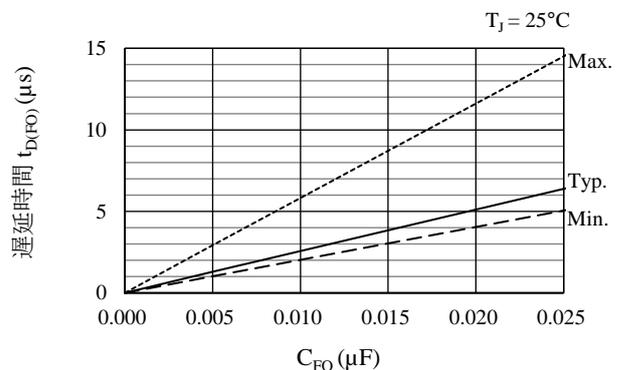


図 12-11 C_{FO} と遅延時間 t_{D(FO)}の関係

12.3. 保護機能

SCM1200MF シリーズは電源電圧低下保護機能 (UVLO : Undervoltage Lockout)、同時オン防止機能、過電流保護機能 (OCP : Overcurrent Protection)、サーマルシャットダウン機能 (TSD : Thermal Shutdown) を搭載しています。これらの保護機能動作時は、FOx 端子からエラー信号を出力し、マイコンから全相の動作を停止できます。また、マイコンからシャットダウン信号を FOx 端子に入力することもできます。以下、HOx はハイサイドスイッチのゲート入力、LOx はローサイドスイッチのゲート入力です (7 項 ブロックダイアグラム参照)。VBx-HSx は VBx 端子と HSx 端子間の電圧です。

12.3.1. エラー出力

以下の保護機能が動作すると、FOx 端子に接続している内部の MOSFET (Q_{FO}) がオンし、FOx 端子は“L”状態 (≦0.5 V) になります。

- 1) ローサイド電源電圧低下保護機能 (UVLO_VCC)
- 2) 過電流保護機能 (OCP)
- 3) 同時オン防止機能
- 4) サーマルシャットダウン (TSD)

FOx 端子が“L”の期間は、各相のハイサイドとローサイドの出力スイッチング素子はオフになります。定常動作時の FOx 端子は“H”状態で、約 5 V を出力します。OCP 動作時の FOx 端子のエラー出力時間は、IC 内部で t_p = 26 μs (typ.) に固定されています (12.3.4 項参照)。エラー信号は、マイコンの割り込みポート (INT) に入力し、t_p 以内に IC への入力信号を停止するなどの処理します。

12.3.2. シャットダウン信号入力

FOx 端子には、シャットダウン信号を入力することができます。FOx 端子を“L”にすると、各相のハイサイドとローサイドの出力スイッチング素子をオフします。

入力するシャットダウン信号の電圧とパルス幅は、表 12-2 の範囲に設定します。

表 12-2 シャットダウン信号

項目	“H”レベル信号	“L”レベル信号
入力電圧	3 V < V _{IN} < 5.5 V	0 V < V _{IN} < 0.5 V
入力パルス幅	≧ 3.0 μs	≧ 3.0 μs

図 12-12 のように FO1、FO2、FO3 端子をショートして使用した場合、いずれかの相の MIC が異常を検出すると、すべての相のハイサイドとローサイドの出力スイッチング素子をオフにできます。

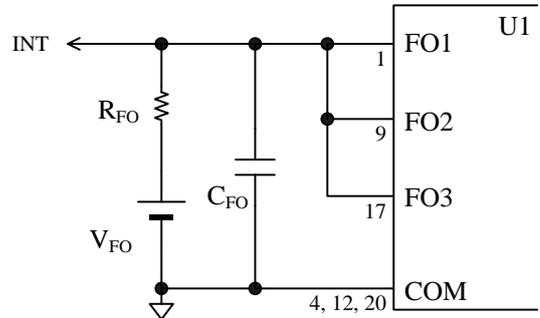


図 12-12 全相シャットダウン回路

12.3.3. 電源電圧低下保護機能 (UVLO)

出力スイッチング素子のゲート駆動電圧が低下すると、スイッチング素子の定常損失が増加して熱破壊する場合があります。これを防止するために、電源電圧低下保護機能 (UVLO) を搭載しています。UVLO はハイサイドとローサイドそれぞれに搭載しています。

12.3.3.1. ハイサイド (UVLO_VB)

図 12-13 にハイサイドの電源電圧低下保護機能 (UVLO_VB) 動作時の波形を示します。

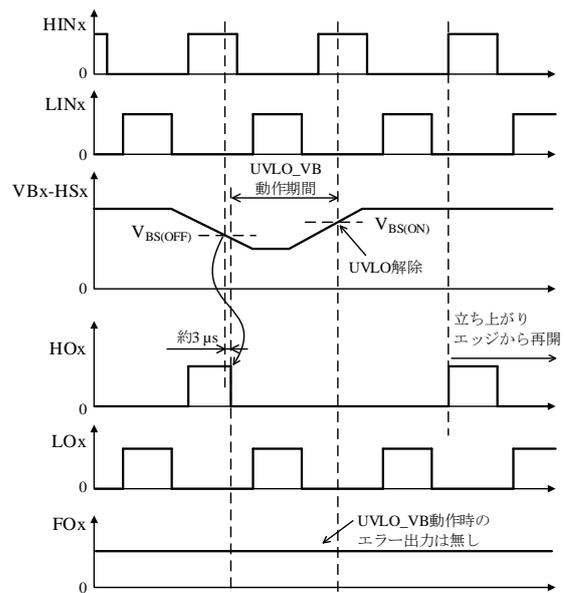


図 12-13 UVLO_VB 動作波形

VBx 端子と HSx 端子の間 (VBx-HSx 間) の電圧が制御動作停止電圧 $V_{BS(OFF)} = 11.0 \text{ V}$ 以下になると UVLO_VB が動作し、HOx を“L”にします。

VBx-HSx 間電圧が上昇し、制御動作開始電圧 $V_{BS(ON)} = 11.5 \text{ V}$ 以上になると、UVLO_VB を解除し最初の入力パルス (アップエッジ) を検出して HOx を“H”にします。UVLO_VB 動作期間は、エラー信号が FOx 端子から出力されません。

ノイズなどによる誤動作を防止するため、VBx 端子には約 $3 \mu\text{s}$ の UVLO_VB フィルタを搭載しています。

12.3.3.2. ローサイド (UVLO_VCC)

図 12-14 にローサイドの電源電圧低下保護機能 (UVLO_VCC) 動作時の波形を示します。

VCCx 端子の電圧が制御動作停止電圧 $V_{CC(OFF)} = 11.0 \text{ V}$ 以下になると UVLO_VCC が動作し、HOx、LOx を“L”にします。VCCx 端子の電圧が上昇し、制御動作開始電圧 $V_{CC(ON)} = 11.5 \text{ V}$ 以上になると、UVLO_VCC を解除し、HOx、LOx は HINx、LINx の入力信号に従って出力します。UVLO_VCC 動作期間は FOx 端子出力が“L”になり、エラー信号を出力します。

ノイズなどによる誤動作を防止するため、VCCx 端子には約 $3 \mu\text{s}$ の UVLO_VCC フィルタを搭載しています。

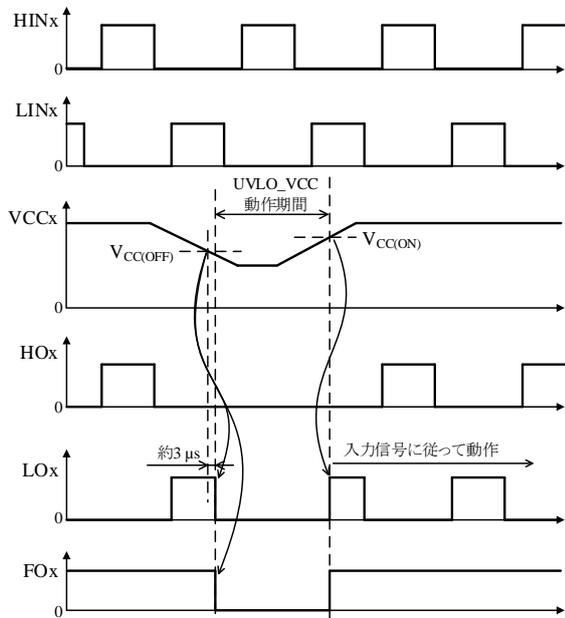


図 12-14 UVLO_VCC 動作波形

12.3.4. 過電流保護機能(OCP)

図 12-15 に OCPx 端子の周辺回路図と内部回路図を示します。図 12-15 のようにシャント抵抗 R_{Sx} の電圧を OCPx 端子に入力し、過電流を検出します。OCPx 端子は内部でプルダウンしており、 R_{Sx} に電流が流れると、電流に比例して OCPx 端子電圧が上昇します。

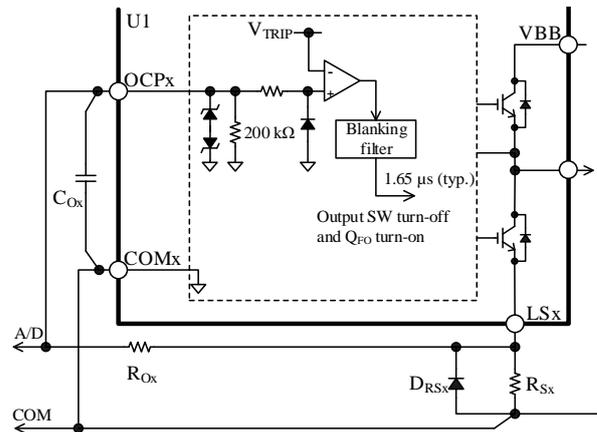


図 12-15 OCPx 端子の周辺回路と内部回路図

図 12-16 に過電流保護機能(OCP)の動作波形を示します。過大電流が流れて OCPx 端子の電圧が過電流保護動作電圧 $V_{TRIP} = 0.50 \text{ V}$ 以上になり、その状態をブランキング時間 $t_{BK} = 1.65 \mu\text{s}$ または $t_{BK} = 0.54 \mu\text{s}$ 以上継続すると、OCP が動作します。OCP が動作すると、出力スイッチング素子をオフして FOx 端子を“L”にします。出力スイッチング素子をオフにすると出力の電流は低下します。OCPx 端子電圧が V_{TRIP} 未満に低下しても、IC は FOx 端子の出力を一定時間 (過電流保護保持時間 $t_P = 26 \mu\text{s}$) “L”に保持します。その後、入力信号に従って動作します。

過電流保護機能の目的は、出力素子の短絡などの異常状態の検出です。短絡モードを繰り返すと出力素子が破壊する可能性があるため、エラー信号検出時は、すぐにマイコンでモータの運転を停止する設定にしてください。

各相の過電流を別々に検出する (3 シャント方式) 場合は、過電流が発生している相の出力素子だけオフし、その相の FOx 端子からエラーを出力します。

図 12-12 のように FO1、FO2、FO3 端子をショートして使用すると、いずれかの相のエラー信号を用いて、すべての相のスイッチング素子をオフすることができます (12.3.2 項参照)。

シャント抵抗は、以下の条件を満たすように設定します。

- シャント抵抗推奨値 R_{Sx} を満たす値 (2 項参照)
- OCPx 端子の入力電圧が絶対最大定格 OCP 端子電圧 V_{OCP} の範囲内 (1 項参照)
- 出力スイッチング素子に流れる電流が絶対最大定格 出力電流 (パルス) I_{OP} 未満 (1 項参照)

R_{Sx} は高周波スイッチング電流が流れるので、内部インダクタンスが小さく、かつ許容損失を満足するものを使用します。

OCPx 端子に接続する CR フィルタ (R_o , C_o) の値を設定する際、 R_o と C_o の時定数が大きすぎると OCPx 端子電圧が V_{TRIP} になるまでに時間がかかり、スイッチング素子が破壊する可能性があります。IC の遅れ時間を考慮し、 R_o と C_o の時定数は表 12-3 のように設定します。

C_o は IC の近くに配置し、OCPx 端子と COMx 端子に最短で接続します。

U、V、W 端子やその配線がグランドと短絡 (地絡) すると、IC は過電流を検出できません。地絡モードになるとスイッチング素子が破壊する可能性があるため、注意が必要です。

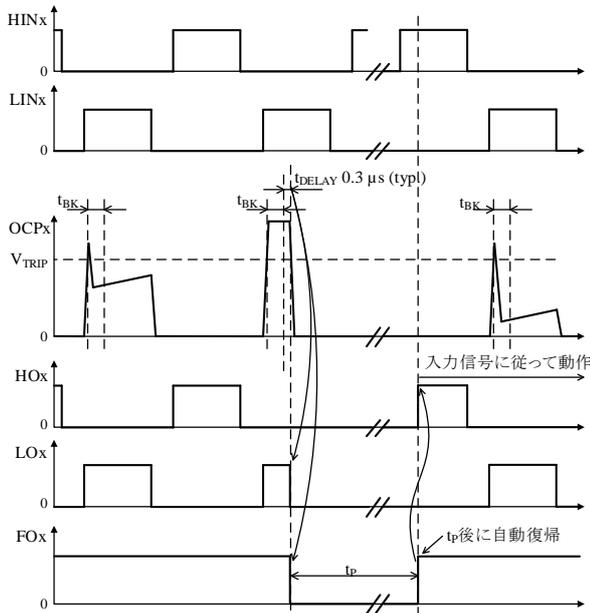


図 12-16 OCP 動作波形

表 12-3 OCPx 端子の CR フィルタの時定数 (参考)

製品名	時定数 (μs)
SCM1242MF SCM1256MF	≤0.22
SCM1260MF	≤1

12.3.5. 同時オン防止機能

信号の誤入力やノイズの影響により、 $HINx$ と $LINx$ に同時に“H”信号を入力した場合、ハイサイドとローサイドのスイッチング素子が同時にオンし、過大な電流が流れてスイッチング素子が破壊する場合があります。これを防止するために同時オン防止機能を搭載しています。

図 12-17 のように、 $HINx$ と $LINx$ に同時に“H”を入力した場合、同時オン防止機能が動作し、ハイサイドとローサイドの出力スイッチング素子をオフにします。同時オン防止機能動作期間は FOx 端子出力が“L”になり、エラー信号を出力します。同時オン状態が解消すると、 HOx , LOx は、 $HINx$, $LINx$ の入力信号に従って出力します。

ノイズなどによる誤動作を防止するため、同時オン防止回路には約 $0.8 \mu s$ のフィルタを搭載しています。

同時オン防止機能にはデッドタイム生成回路はありません。 $HINx$, $LINx$ の入力信号はデッドタイムの設定が必要です (12.2.7 項参照)。

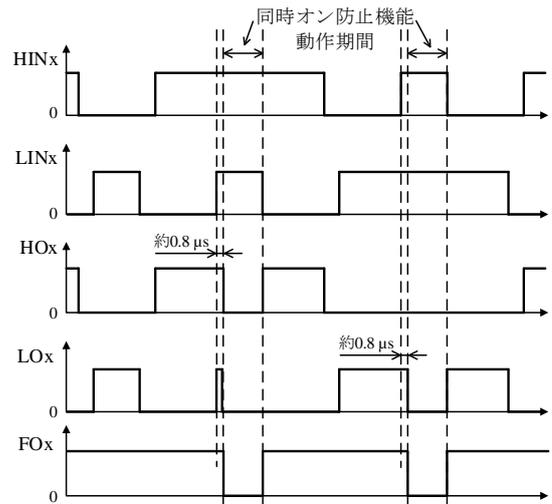


図 12-17 同時オン防止機能動作波形

12.3.6. サーマルシャットダウン (TSD)

本 IC はサーマルシャットダウン (TSD) を搭載しており、図 12-18 のように、過負荷による消費電力の増加や IC 周囲温度の上昇などで IC が過熱状態になると、ハイサイドとローサイドの出力スイッチング素子をオフにします。

温度は制御 IC 内の TSD 回路で検出しています (7 項ブロックダイアグラム参照)。制御部の温度がサーマルシャットダウン動作温度 $T_{DH} = 150 \text{ }^\circ\text{C}$ (typ.) を超えると TSD が動作します。その後、制御部の温度がサーマルシャットダウン動作解除温度

SCM1200MF シリーズ

$T_{DL} = 120\text{ }^{\circ}\text{C}$ (typ.)以下になると TSD を解除します。
TSD 解除後は入力信号に従って動作します。

TSD 動作期間は FOx 端子出力が“L”になり、エラー信号を出力します。

ただし、出力スイッチング素子のジャンクション温度と検出温度は一致しないため、過熱破壊防止用として TSD 機能を使用しないでください。

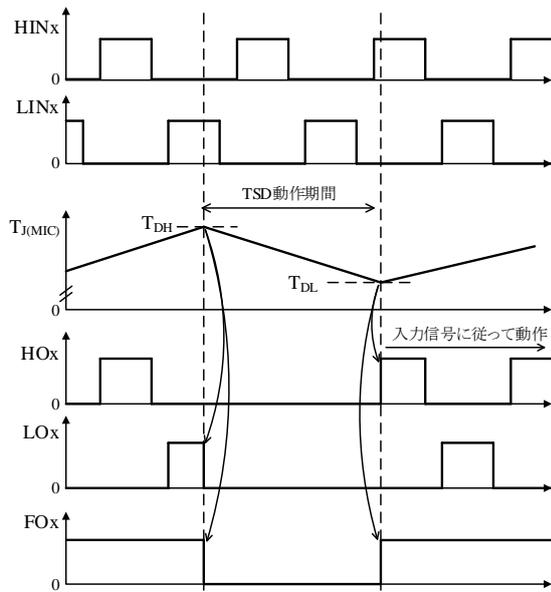


図 12-18 TSD 動作波形

13. 設計上の注意点

本項の端子記号は前項と同様の表記方法を用います。

13.1. パターンレイアウト

図 13-1 のようにモータドライバは、高周波かつ高電圧の電流経路が存在し、基板のパターンや部品の実装条件が、動作、ノイズ、損失などに大きく影響します。そのため、高周波電流ループは極力小さく、パターンを太くして、ラインインピーダンスを低くする必要があります。また、グラウンドラインは輻射ノイズに大きな影響を与えるため、極力太く、短く配線します。

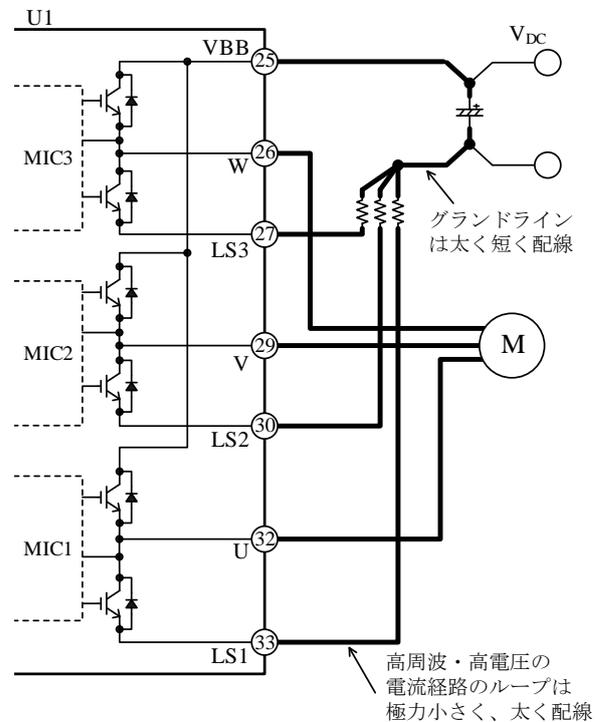


図 13-1 高周波かつ高電圧の電流経路

13.2. 放熱器を取り付ける際の注意

放熱器を取り付ける際には以下の注意が必要です。

- φ7 の平座金付きの M3 ネジの使用を推奨します。トルクドライバを使用し、締付けトルクの最大値の 30% を目安に 2 か所のネジを仮締めしてから、4 項 機械的特性の締付けトルクの範囲で固定してください。
- 放熱器を取り付ける場合はシリコングリースの使用を推奨します。放熱シート、絶縁シートは締付け時にしわが発生し、パッケージが割れる原因になるため、これらを使用する際には、十分な検討が必要です。
- シリコングリースを塗布する際は、放熱器と IC の間に異物がないことを確認してください。また、製品の端子に極力付着しないように注意が必要です。シリコングリースの塗布条件は以下のとおりです。
 - 塗布厚：100 μm
 - 放熱器の平坦度：±100 μm
 - 放熱器に塗布する場合の推奨塗布範囲は 図 13-2 参照

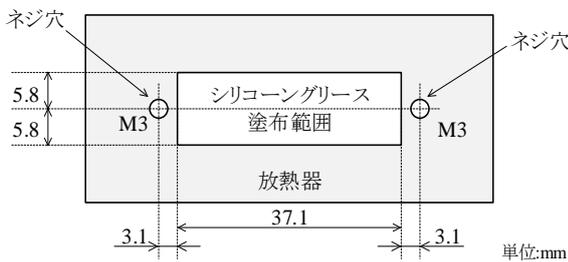


図 13-2 シリコングリースの塗布範囲 (参考)

13.3. IC の特性を測定する際の注意

IC 単体で内部のスイッチング素子の耐圧やリーク電流を測定する場合、各スイッチング素子のゲートとエミッタは同電位である必要があります。また、ハイサイドすべてのコレクタが IC 内部で VBB 端子に接続しているため、注意が必要です。

出力端子 (U、V、W) は各相のハイサイド素子のエミッタ、LSx 端子は各相のローサイド素子のエミッタに接続しています。また、ハイサイド素子のゲートは出力端子、ローサイド素子のゲートは COMx 端子にプルダウンされています。

出力端子、LSx 端子、COMx 端子を適切に処理して耐圧やリーク電流を測定しないと、スイッチング素子を破壊する可能性があるため、注意が必要です。

例として、図 13-3 に U 相ハイサイド素子(Q_{1H})、図 13-4 に U 相ローサイド素子(Q_{1L})の耐圧測定回路を示します。記載のない端子はすべてオープンです。

耐圧やリーク電流の測定時は、測定する相のグラウンドと測定しない相のグラウンドを分離します。測定しない相の LSx 端子、COMx 端子は、フローティング状態で同電位にします。

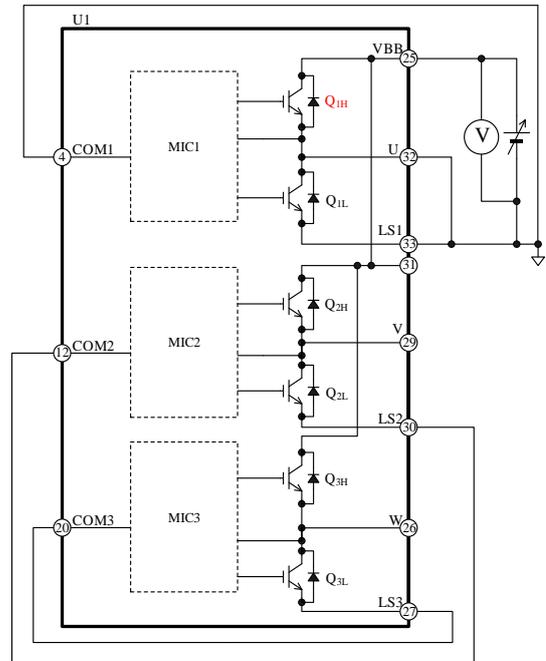


図 13-3 U 相ハイサイド素子(Q_{1H})耐圧測定回路

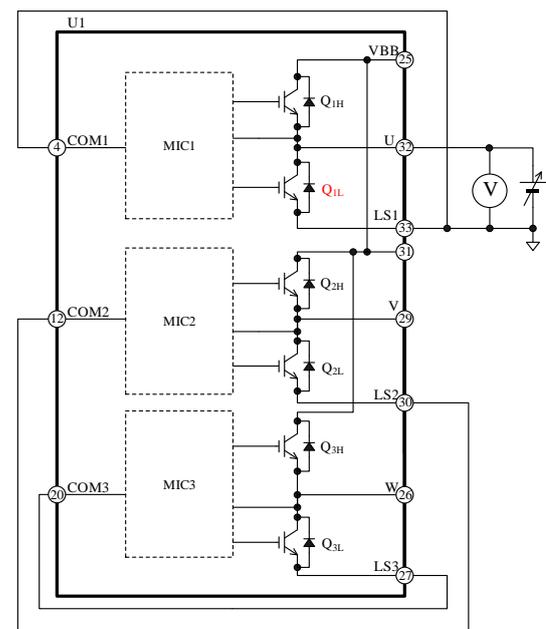


図 13-4 U 相ローサイド素子(Q_{1L})耐圧測定回路

14. 損失の計算とジャンクション温度の推定

正弦波駆動、3相変調方式において、IGBT（1素子あたり）の損失とジャンクション温度の推定方法を以下に示します。

IGBTの損失は、定常損失 P_{ON} とスイッチング損失 P_{SW} の合計です。IGBTの損失とジャンクション温度は、以下の手順で算出します。

なお、損失とジャンクション温度は、弊社HPに掲載している計算ツールを用いて簡単に計算できます。

- DT0051 : SCM1200MF シリーズ損失計算ツール
http://www.semicon.sanken-ele.co.jp/calc-tool/igbt1_caltool_jp.html

14.1. IGBTの定常損失 P_{ON}

定常損失 P_{ON} は、15.3.1 項の $V_{CE(SAT)}-I_C$ 特性より、図 14-1 のように I_C の使用範囲における 1 次近似式 ($V_{CE(SAT)} = \alpha \times I_C + \beta$) を算出します。

IGBTの定常損失 P_{ON} は、この 1 次近似式の係数を用いて、次式で計算できます。

$$\begin{aligned}
 P_{ON} &= \frac{1}{2\pi} \int_0^\pi V_{CE(SAT)}(\varphi) \times I_C(\varphi) \times DT \times d\varphi \\
 &= \frac{1}{2} \alpha \left(\frac{1}{2} + \frac{4}{3\pi} M \times \cos\theta \right) I_M^2 \\
 &\quad + \frac{\sqrt{2}}{\pi} \beta \left(\frac{1}{2} + \frac{\pi}{8} M \times \cos\theta \right) I_M \quad (4)
 \end{aligned}$$

ここで、

$V_{CE(SAT)}$: IGBT のコレクタ-エミッタ間飽和電圧(V)

I_C : IGBT のコレクタ電流(A)

DT : オンデューティ

$$DT = \frac{1 + M \times \sin(\varphi + \theta)}{2}$$

M : 変調率(0~1)

$\cos\theta$: モータ力率(0~1)

I_M : モータ電流実効値(A)

α : $V_{CE(SAT)}-I_C$ 特性の 1 次近似式の傾き

β : $V_{CE(SAT)}-I_C$ 特性の 1 次近似式の切片

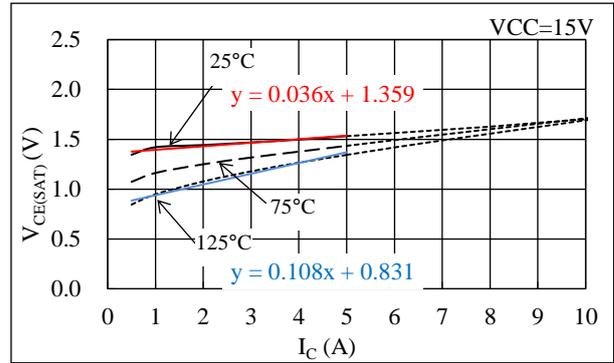


図 14-1 $V_{CE(SAT)}-I_C$ 特性の 1 次近似式

14.2. IGBTのスイッチング損失 P_{SW}

モータの実効電流が I_M のときの IGBT のスイッチング損失 P_{SW} は、式(5)で算出できます。

$$P_{SW} = \frac{\sqrt{2}}{\pi} \times f_c \times \alpha_E \times I_M \times \frac{V_{DC}}{300} \quad (5)$$

ここで、

f_c : PWM キャリア周波数(Hz)

V_{DC} : 主電源電圧(V)

(VBB 端子入力電圧)

α_E : スwitching損失グラフの傾き

(0 項スイッチング損失参照)

14.3. IGBTのジャンクション温度の推定

IGBTのジャンクション温度 T_J は式(6)で推定できます。

$$T_J = R_{(J-C)Q} \times (P_{ON} + P_{SW}) + T_C \quad (6)$$

ここで、

$R_{(J-C)Q}$: 1 素子動作時の IGBT のジャンクション-ケース間熱抵抗($^{\circ}C/W$)

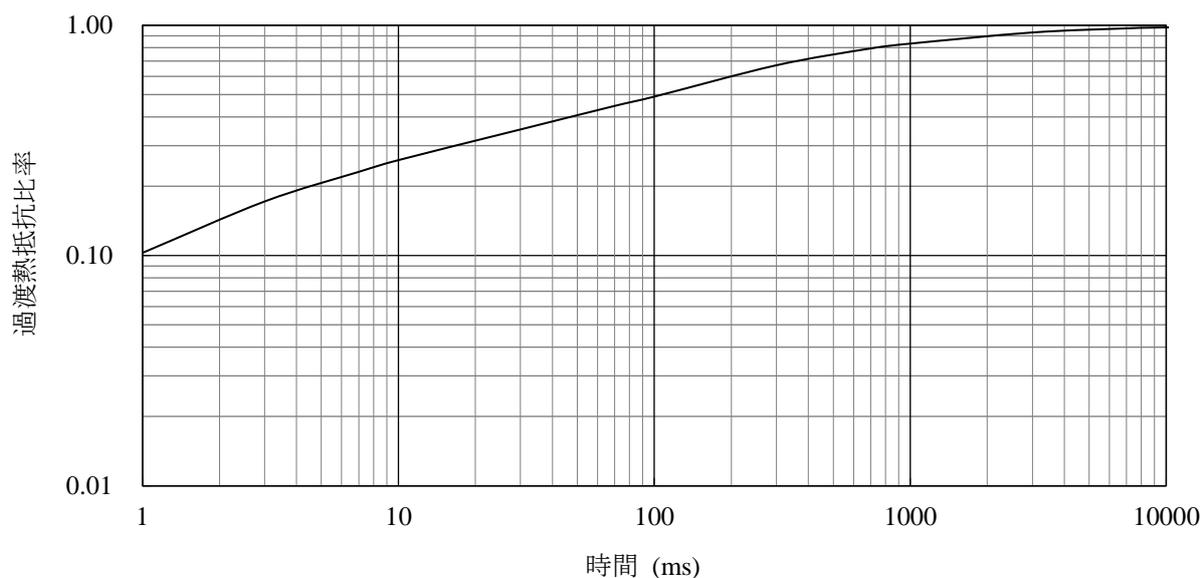
T_C : ケース温度($^{\circ}C$) (測定位置は図 3-1 参照)

15. 代表特性グラフ

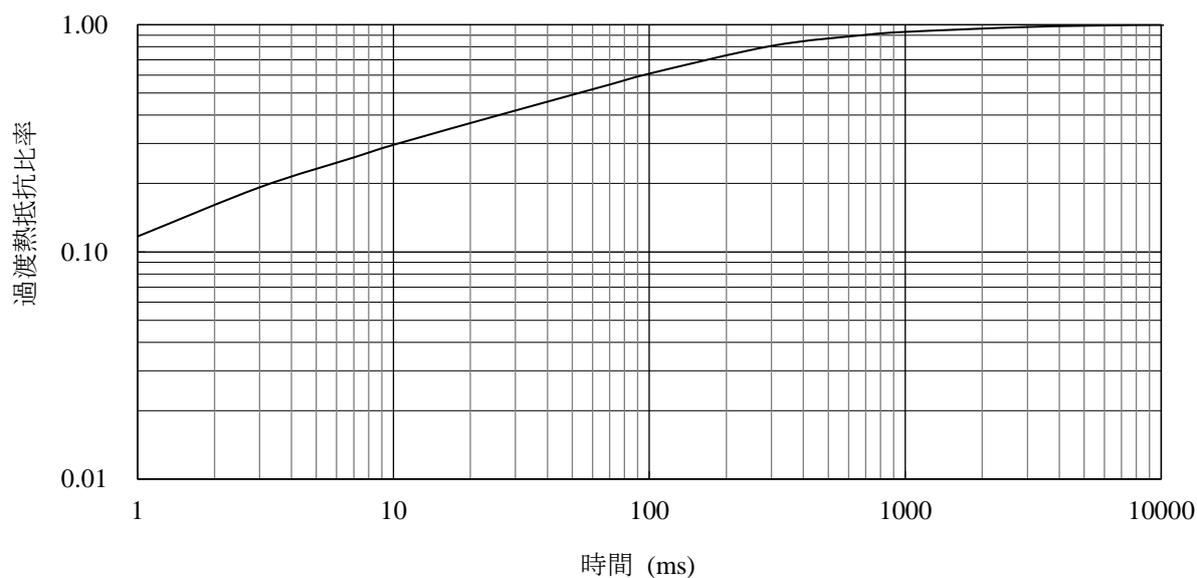
15.1. 過渡熱抵抗特性グラフ

以下に、それぞれの定常熱抵抗を 1 とした場合の過渡熱抵抗（過渡熱抵抗比率）を示します。

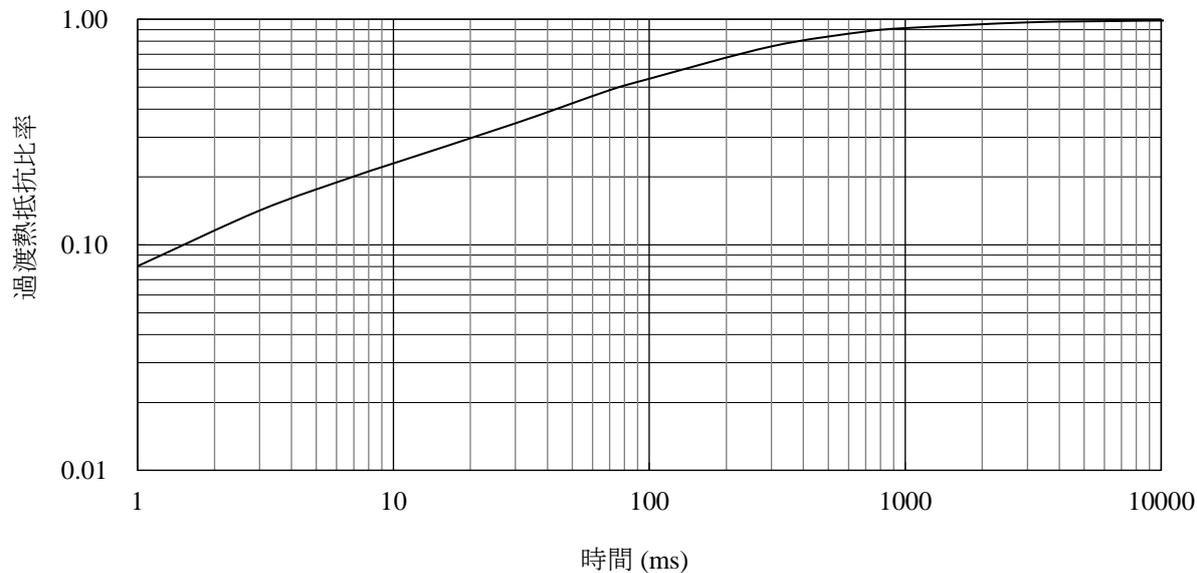
15.1.1. SCM1261MF



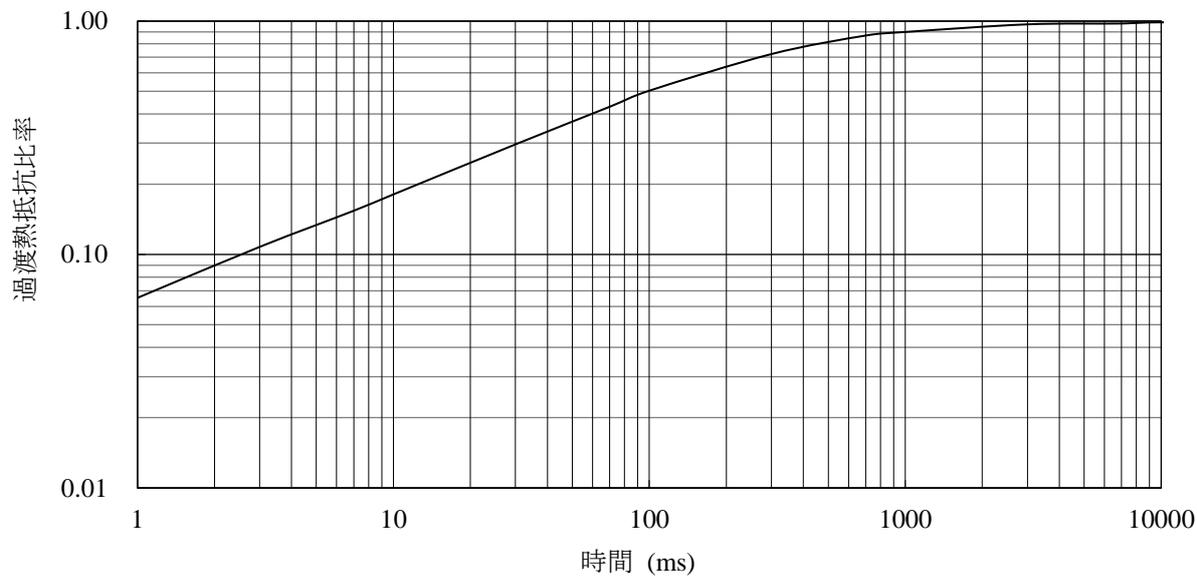
15.1.2. SCM1242MF、SCM1263MF



15.1.3. SCM1265MF



15.1.4. SCM1256MF



15.2. 制御部代表特性グラフ

図 15-1～図 15-27 に制御部の各種依存性および温度特性を示します。T_Jは制御部のジャンクション温度です。

表 15-1 制御部代表特性一覧

図番号	表題
図 15-1	制御電源電流 (3 相) I _{CC} 温度特性
図 15-2	VCC _x 端子電圧 V _{CC} - 制御電源電流(3 相)I _{CC} 特性
図 15-3	制御電源電流 (1 相) I _{BS} 温度特性 (HIN _x = 0 V)
図 15-4	制御電源電流 (1 相) I _{BS} 温度特性 (HIN _x = 5 V)
図 15-5	VB _x 端子電圧 V _B - 制御電源電流 (1 相) I _{BS} 特性 (HIN _x = 0 V)
図 15-6	制御動作開始電圧 V _{BS(ON)} 温度特性
図 15-7	制御動作停止電圧 V _{BS(OFF)} 温度特性
図 15-8	制御動作開始電圧 V _{CC(ON)} 温度特性
図 15-9	制御動作停止電圧 V _{CC(OFF)} 温度特性
図 15-10	UVLO_VB フィルタ時間温度特性
図 15-11	UVLO_VCC フィルタ時間温度特性
図 15-12	HIN _x 端子、LIN _x 端子入力電流 I _{IN} 温度特性
図 15-13	ハイレベル入力しきい電圧 V _{IH} 温度特性
図 15-14	ローレベル入力しきい電圧 V _{IL} 温度特性
図 15-15	ハイサイド オン信号伝達時間温度特性 (HIN _x から HO _x まで)
図 15-16	ハイサイド オフ信号伝達時間温度特性 (HIN _x から HO _x まで)
図 15-17	ローサイド オン信号伝達時間 温度特性 (LIN _x から LO _x まで)
図 15-18	ローサイド オフ信号伝達時間 温度特性 (LIN _x から LO _x まで)
図 15-19	ハイサイド最小応答パルス幅 t _{HIN(MIN)} 温度特性
図 15-20	ローサイド最小応答パルス幅 t _{LIN(MIN)} 温度特性
図 15-21	出力パルス幅(typ.)t _{HO} 、t _{LO} - 入力パルス幅 t _{HIN} 、t _{LIN} 特性
図 15-22	定常動作時 FO _x 端子電圧 V _{FOL} 温度特性
図 15-23	過電流保護動作電圧 V _{TRIP} 温度特性
図 15-24	ブランキング時間 t _{BK} + 内部遅延時間 t _D 温度特性 (SCM124xMF)
図 15-25	ブランキング時間 t _{BK} + 内部遅延時間 t _D 温度特性 (SCM126xMF)
図 15-26	過電流保護保持時間 t _P 温度特性
図 15-27	同時オン防止機能フィルタ時間温度特性

SCM1200MF シリーズ

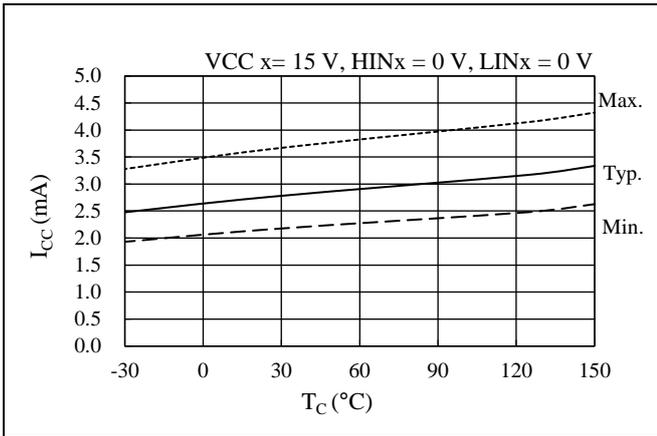


図 15-1 制御電源電流 (3 相) I_{CC} 温度特性

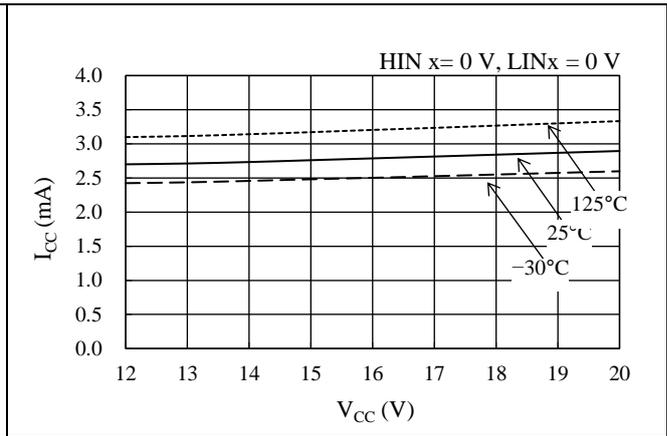


図 15-2 V_{CCx} 端子電圧 V_{CC} - 制御電源電流 (3 相) I_{CC} 特性

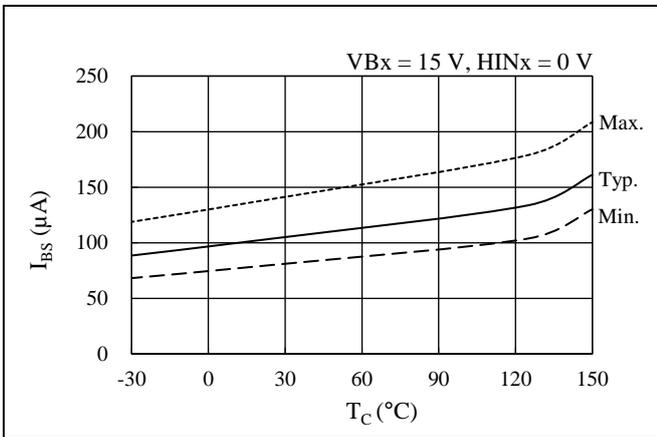


図 15-3 制御電源電流 (1 相) I_{BS} 温度特性 ($HINx = 0 V$)

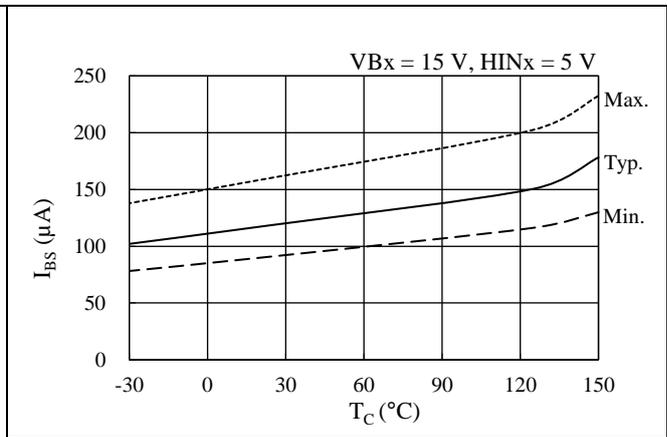


図 15-4 制御電源電流 (1 相) I_{BS} 温度特性 ($HINx = 5 V$)

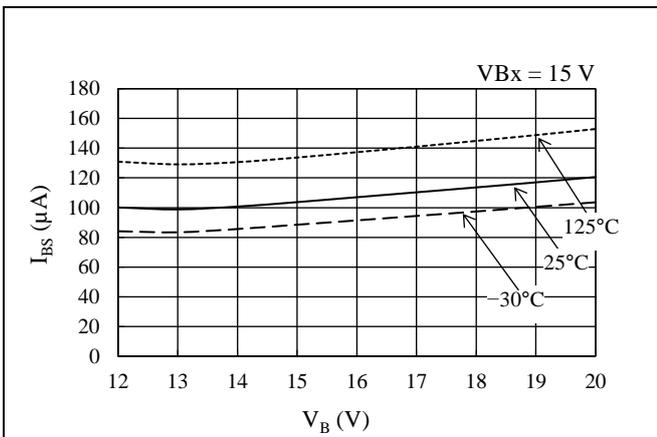


図 15-5 V_{Bx} 端子電圧 V_B - 制御電源電流 (1 相) I_{BS} 特性 ($HINx = 0 V$)

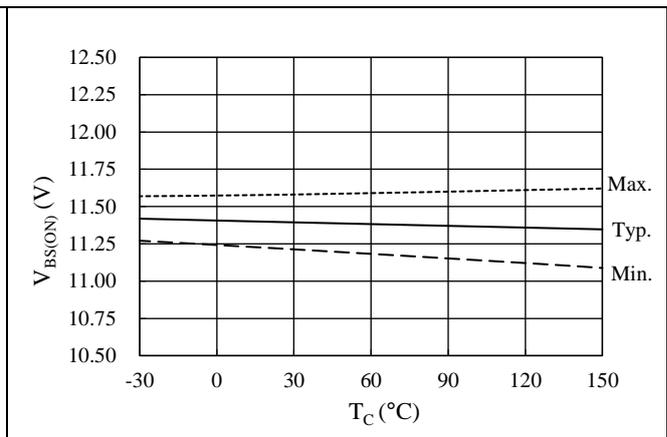


図 15-6 制御動作開始電圧 $V_{BS(ON)}$ 温度特性

SCM1200MF シリーズ

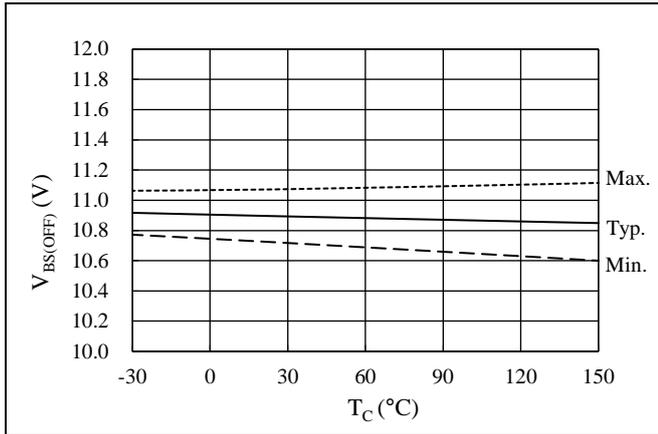


図 15-7 制御動作停止電圧 $V_{BS(OFF)}$ 温度特性

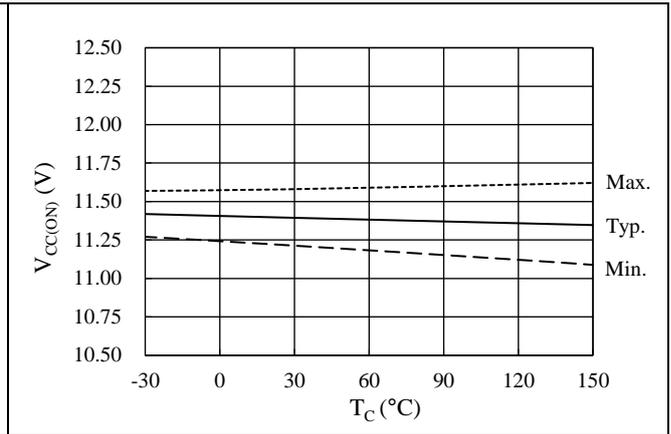


図 15-8 制御動作開始電圧 $V_{CC(ON)}$ 温度特性

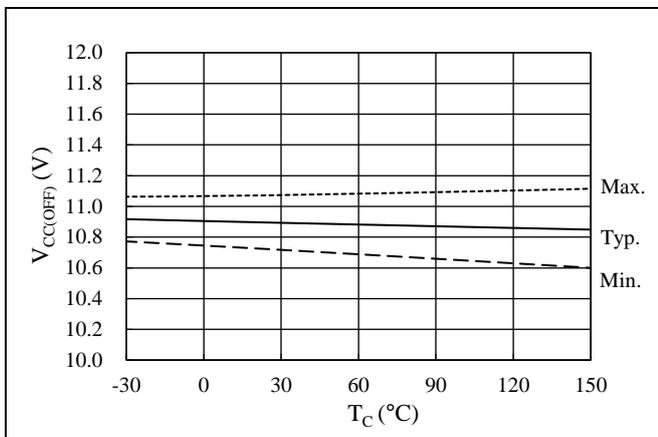


図 15-9 制御動作停止電圧 $V_{CC(OFF)}$ 温度特性

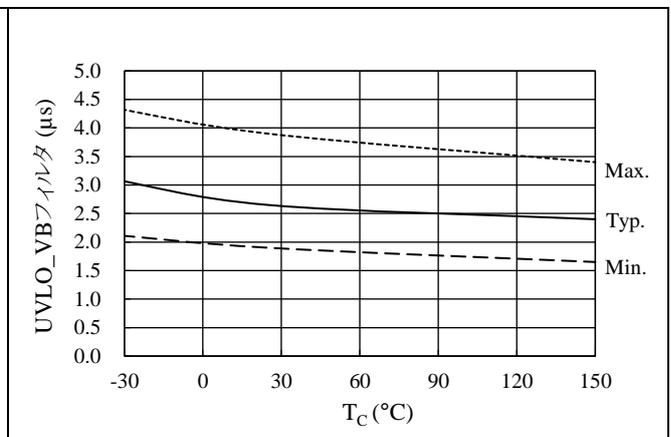


図 15-10 UVLO_VB フィルタ時間温度特性

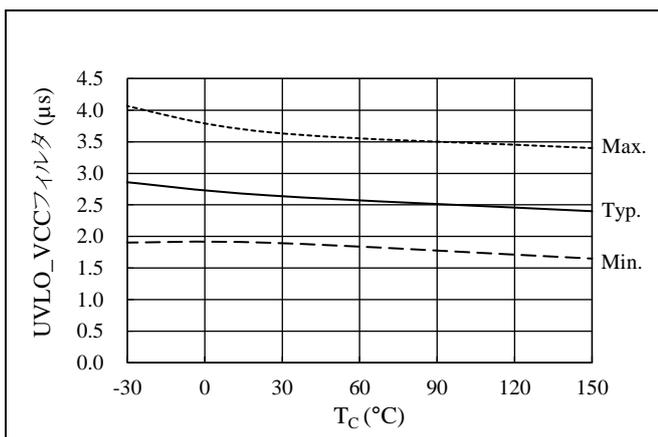


図 15-11 UVLO_VCC フィルタ時間温度特性

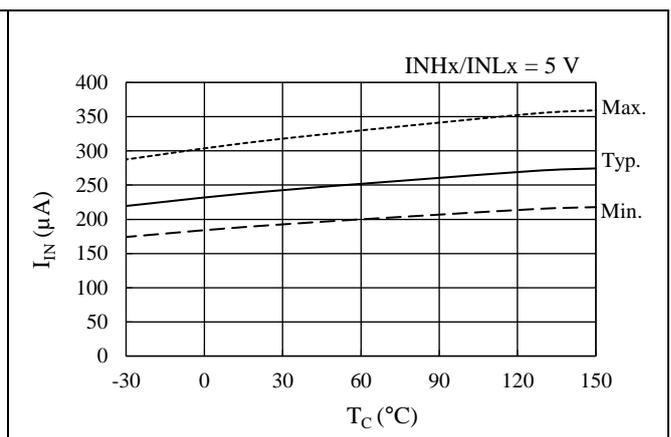


図 15-12 HINx 端子、LINx 端子入力電流 I_{IN} 温度特性

SCM1200MF シリーズ

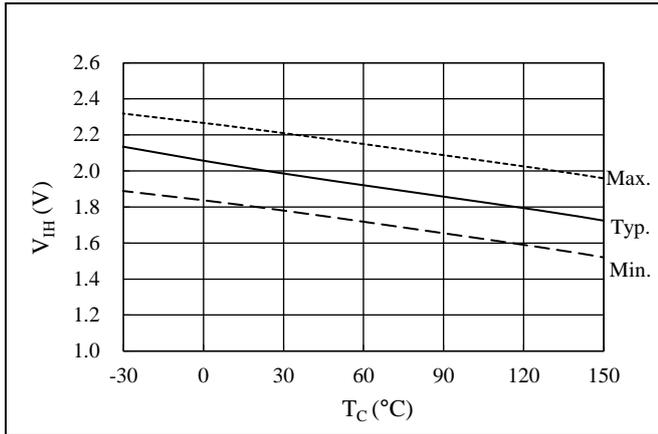


図 15-13 ハイレベル入力しきい電圧 V_{IH} 温度特性

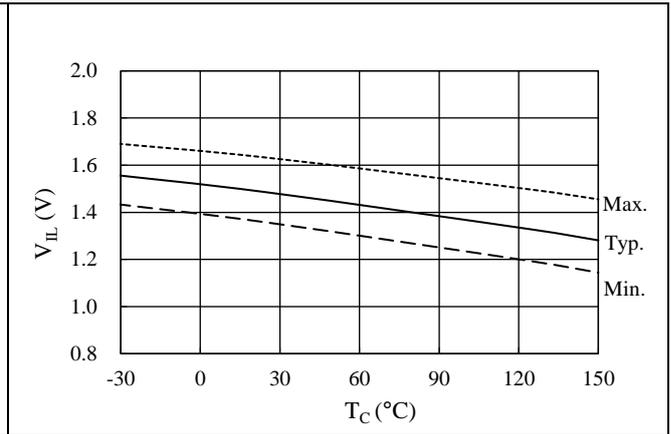


図 15-14 ローレベル入力しきい電圧 V_{IL} 温度特性

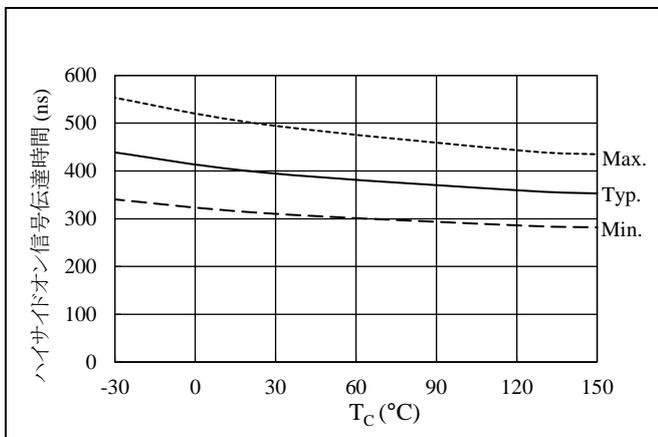


図 15-15 ハイサイド オン信号伝達時間温度特性 (HINx から HOx まで)

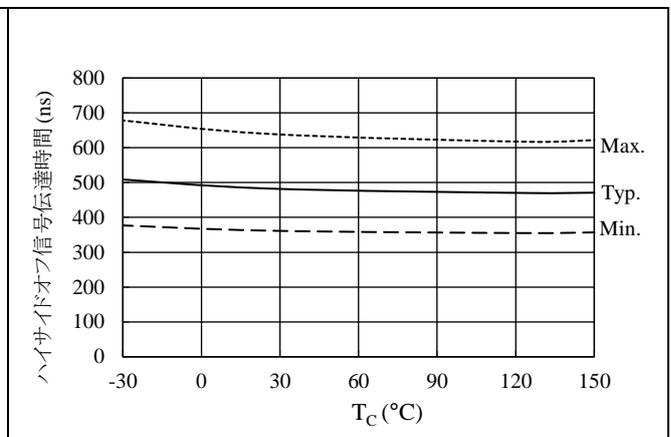


図 15-16 ハイサイド オフ信号伝達時間温度特性 (HINx から HOx まで)

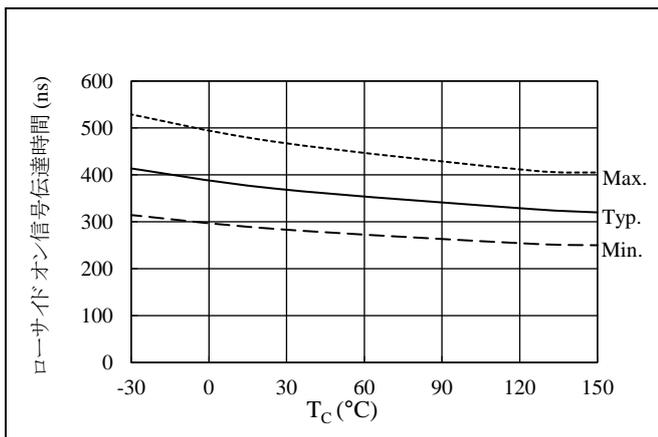


図 15-17 ローサイド オン信号伝達時間 温度特性 (LINx から LOx まで)

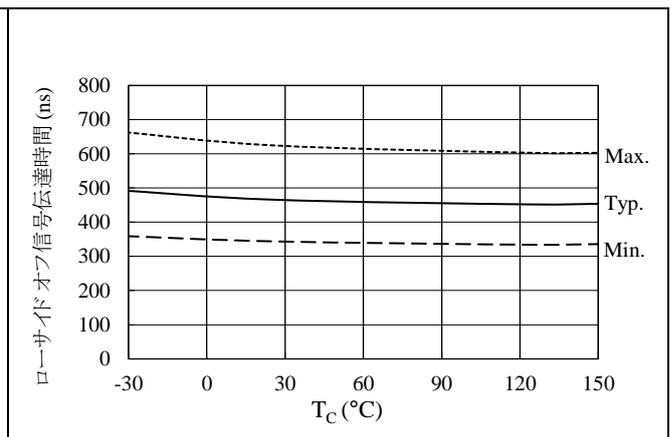


図 15-18 ローサイド オフ信号伝達時間 温度特性 (LINx から LOx まで)

SCM1200MF シリーズ

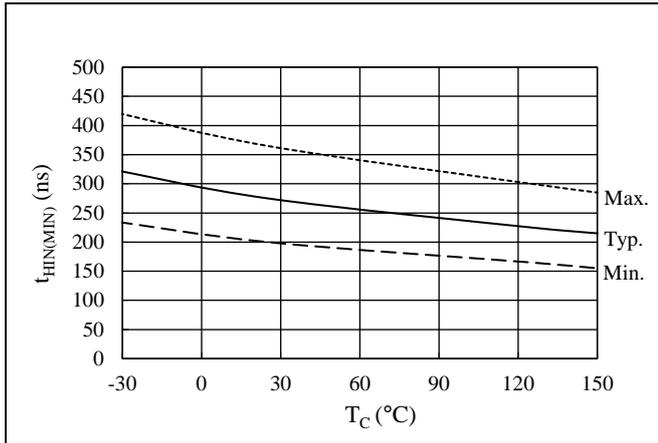


図 15-19 ハイサイド最小応答パルス幅 $t_{HIN(MIN)}$ 温度特性

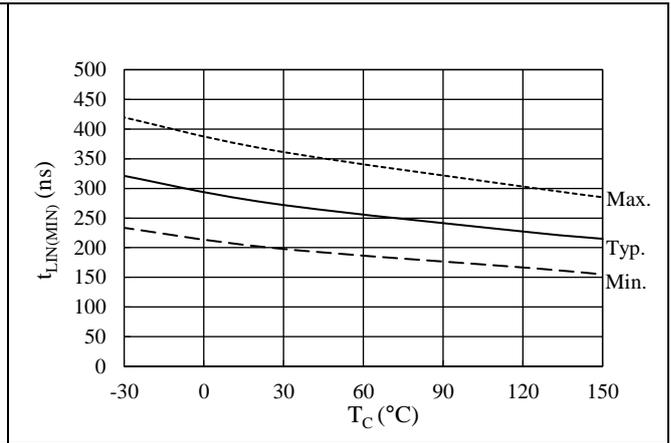


図 15-20 ローサイド最小応答パルス幅 $t_{LIN(MIN)}$ 温度特性

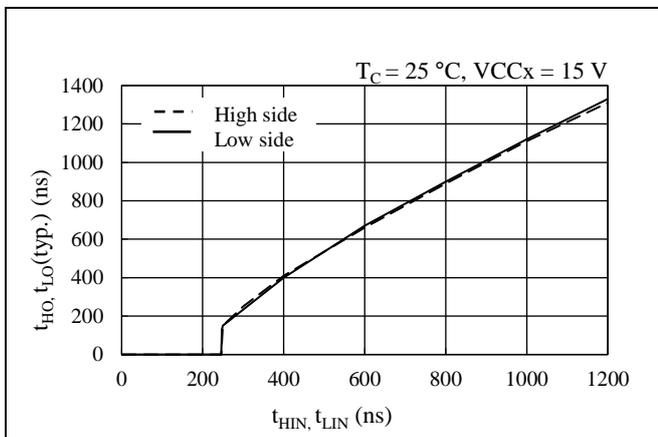


図 15-21 出力パルス幅(typ.) t_{HO} 、 t_{LO} – 入力パルス幅 t_{HIN} 、 t_{LIN} 特性

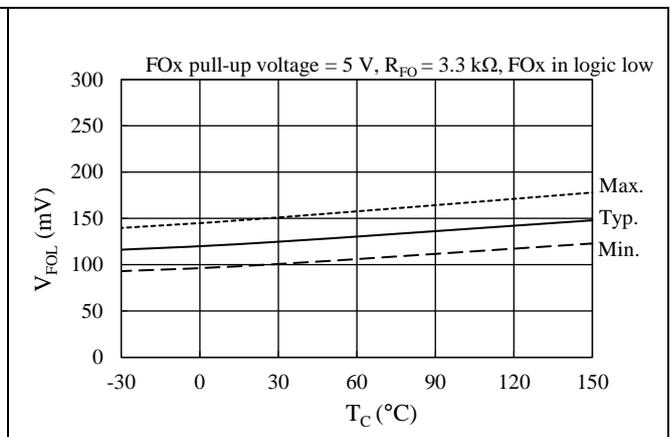


図 15-22 定常動作時 FOx 端子電圧 V_{FOL} 温度特性

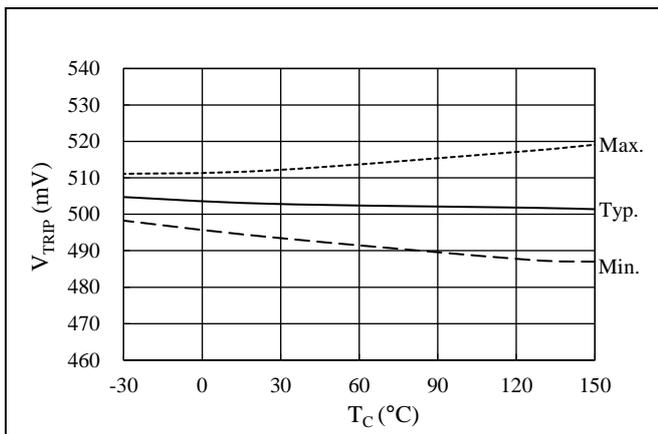


図 15-23 過電流保護動作電圧 V_{TRIP} 温度特性

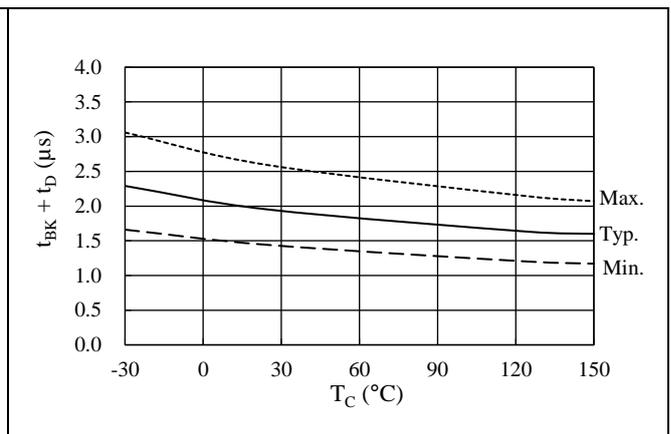


図 15-24 ブランキング時間 t_{BK} + 内部遅延時間 t_D 温度特性 (SCM124xMF)

SCM1200MF シリーズ

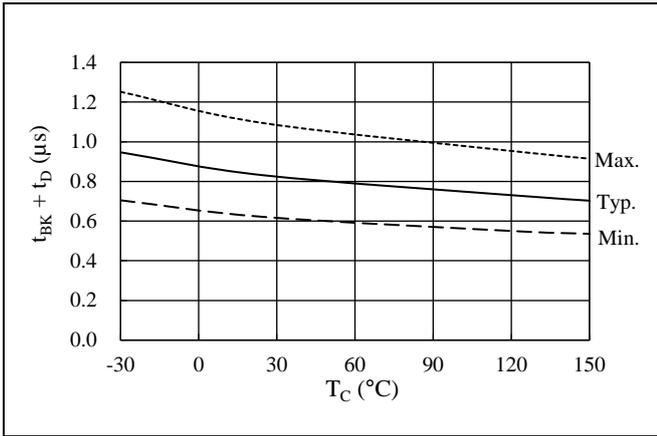


図 15-25 ブランキング時間 t_{BK} + 内部遅延時間 t_D 温度特性 (SCM126xMF)

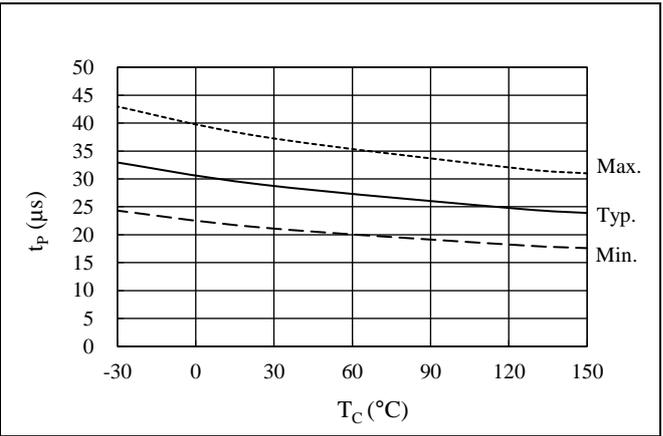


図 15-26 過電流保護保持時間 t_P 温度特性

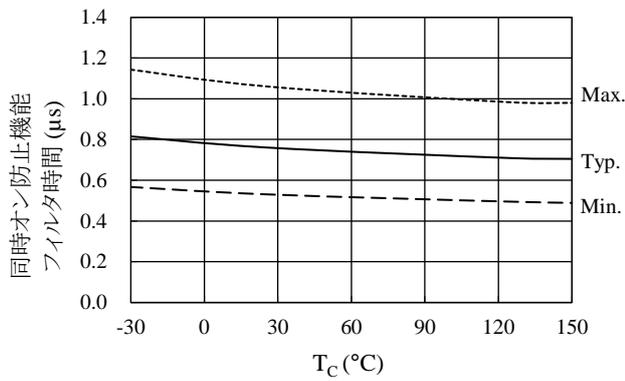


図 15-27 同時オン防止機能フィルタ時間温度特性

SCM1200MF シリーズ

15.3. 出力特性グラフ

15.3.1. 出力素子特性

15.3.1.1. SCM1261M

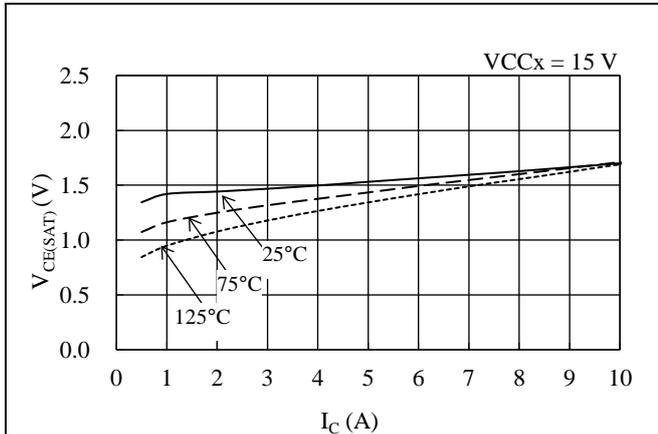


図 15-28 IGBT $V_{CE(SAT)}$ - I_C 特性

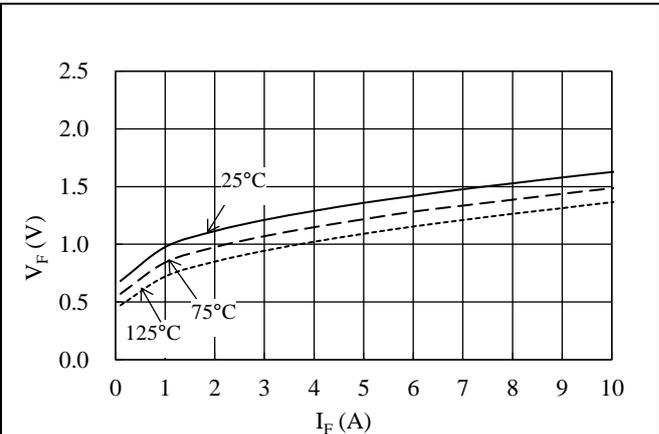


図 15-29 フリーホイールダイオード V_F - I_F 特性

15.3.1.2. SCM1242MF、SCM1263MF

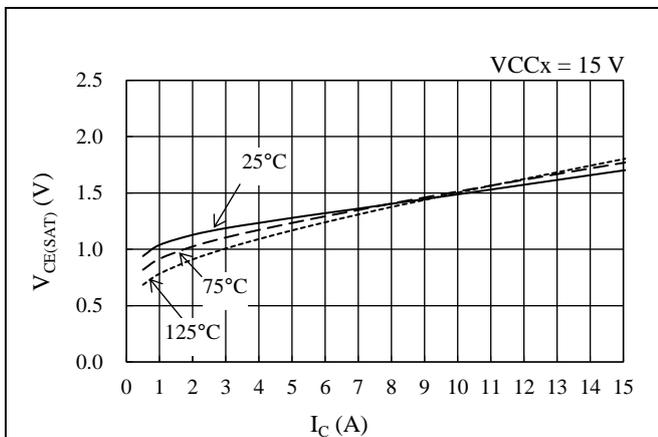


図 15-30 IGBT $V_{CE(SAT)}$ - I_C 特性

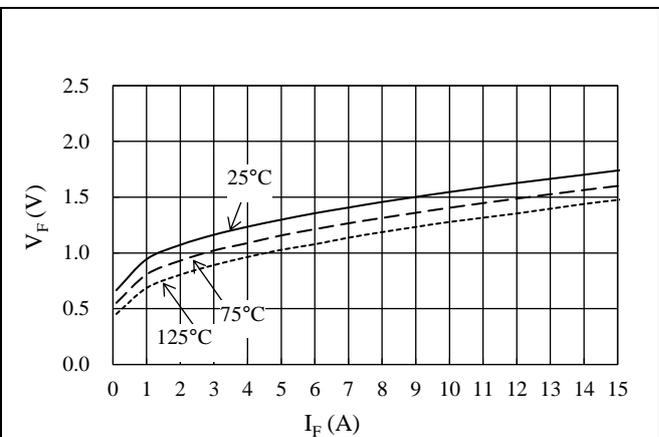


図 15-31 フリーホイールダイオード V_F - I_F 特性

SCM1200MF シリーズ

15.3.1.3. SCM1265MF

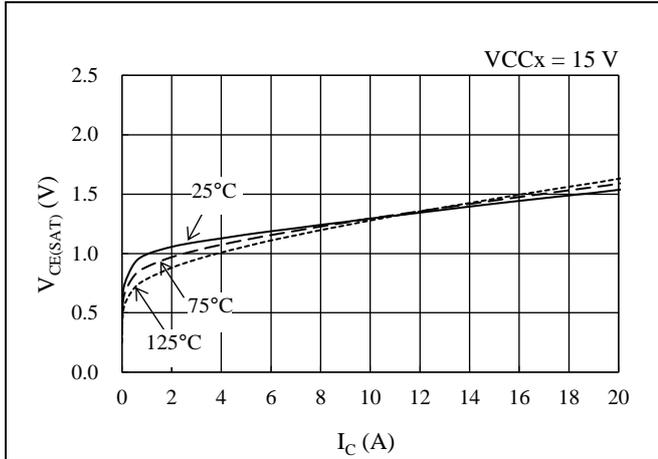


図 15-32 IGBT $V_{CE(SAT)}$ - I_C 特性

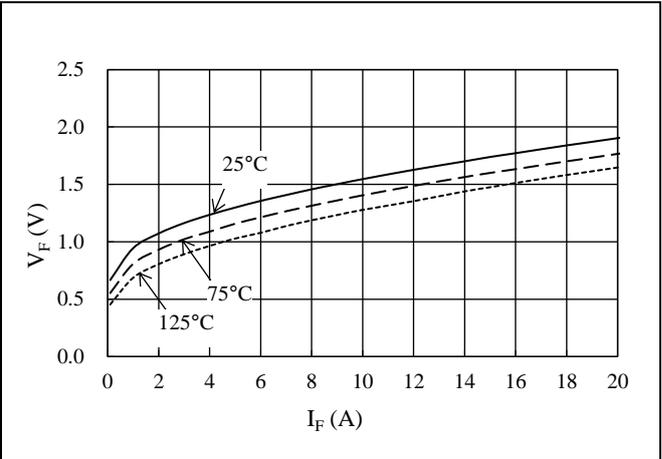


図 15-33 フリーホイールダイオード V_F - I_F 特性

15.3.1.4. SCM1256MF

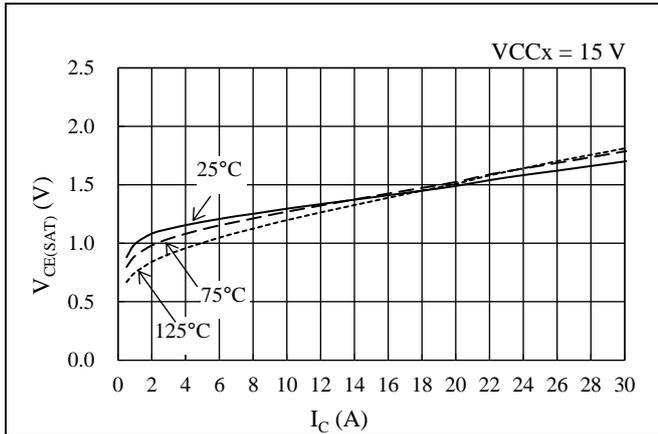


図 15-34 IGBT $V_{CE(SAT)}$ - I_C 特性

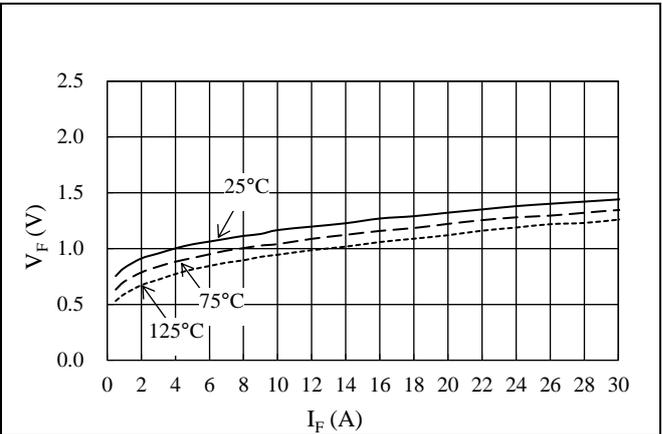


図 15-35 フリーホイールダイオード V_F - I_F 特性

SCM1200MF シリーズ

15.3.2. スイッチング損失特性グラフ

VBB 端子電圧 = 300 V、L 負荷におけるハーフブリッジ動作時のスイッチング損失です。

15.3.2.1. SCM1261MF

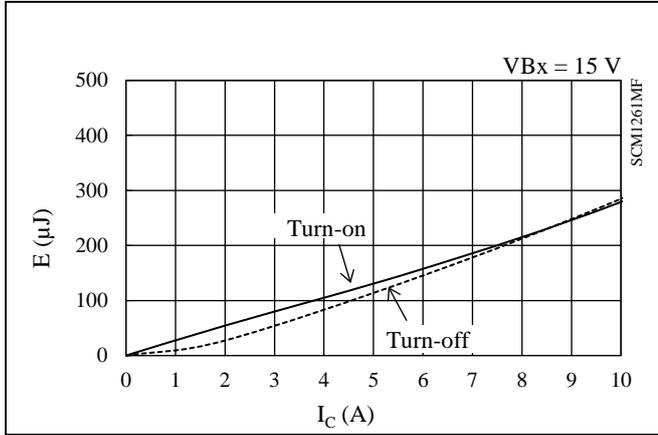


図 15-36 ハイサイドスイッチング損失特性
($T_J = 25\text{ }^\circ\text{C}$)

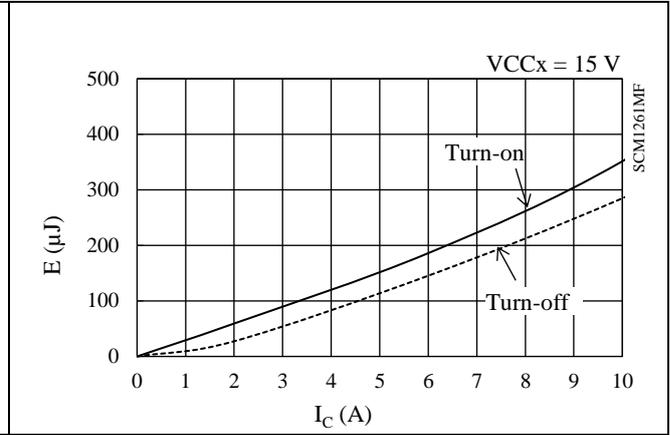


図 15-37 ローサイドスイッチング損失特性
($T_J = 25\text{ }^\circ\text{C}$)

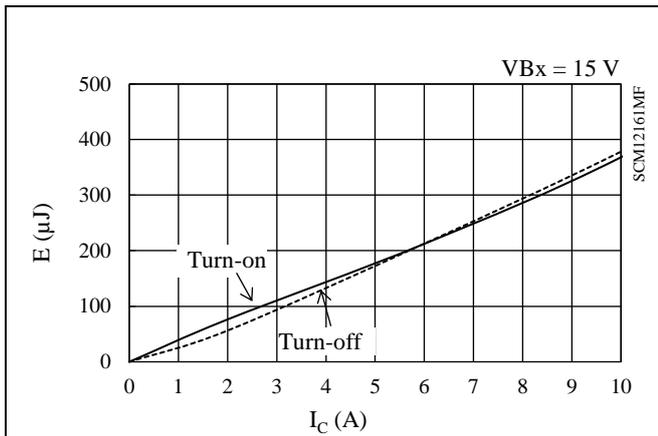


図 15-38 ハイサイドスイッチング損失特性
($T_J = 125\text{ }^\circ\text{C}$)

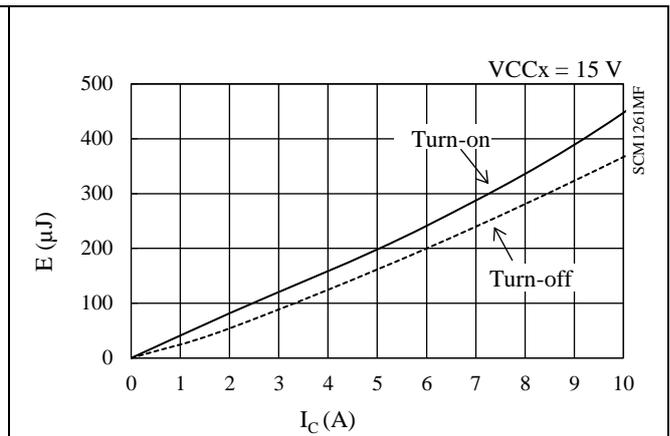


図 15-39 ローサイドスイッチング損失特性
($T_J = 125\text{ }^\circ\text{C}$)

15.3.2.2. SCM1242MF

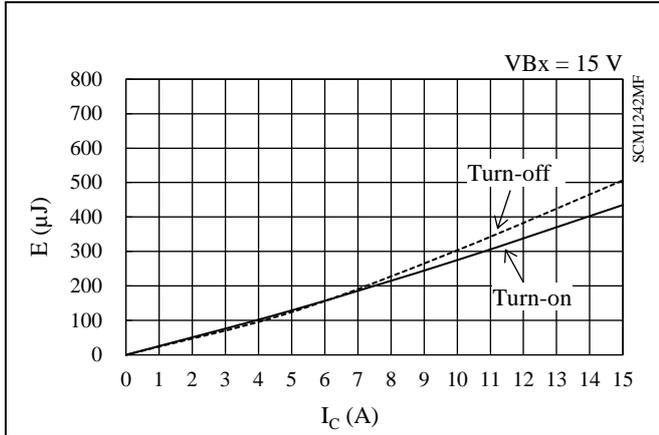


図 15-40 ハイサイドスイッチング損失特性
($T_J = 25\text{ }^\circ\text{C}$)

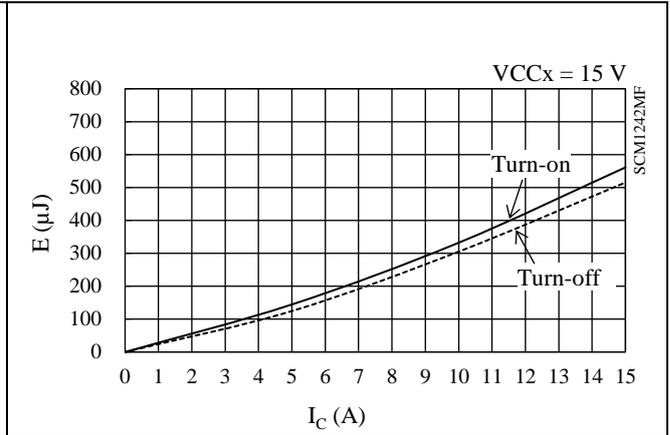


図 15-41 ローサイドスイッチング損失特性
($T_J = 25\text{ }^\circ\text{C}$)

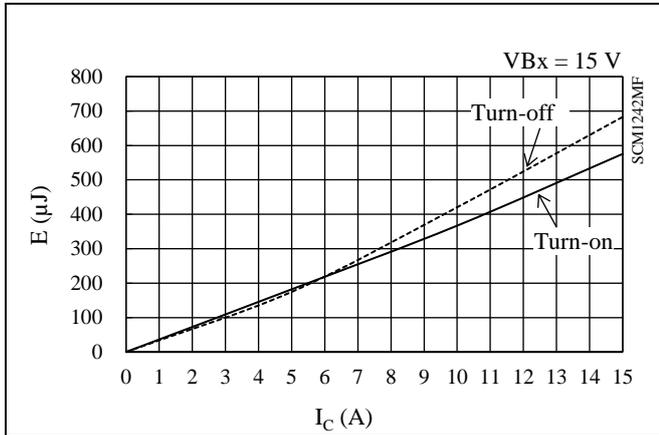


図 15-42 ハイサイドスイッチング損失特性
($T_J = 125\text{ }^\circ\text{C}$)

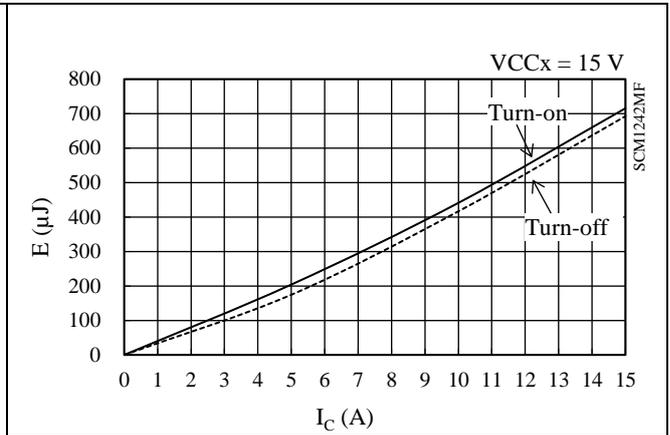


図 15-43 ローサイドスイッチング損失特性
($T_J = 125\text{ }^\circ\text{C}$)

15.3.2.3. SCM1263MF

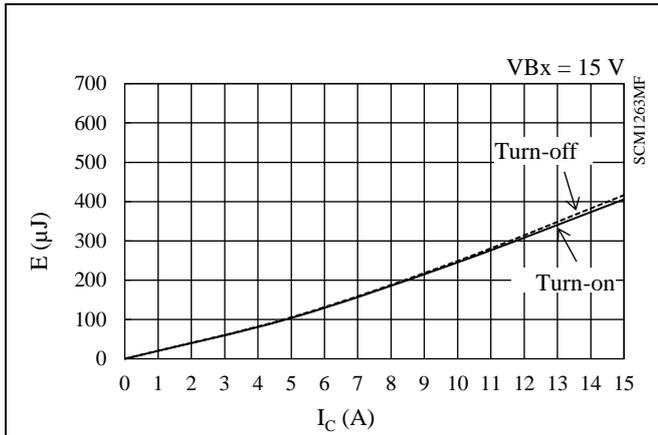


図 15-44 ハイサイドスイッチング損失特性
($T_J = 25\text{ }^\circ\text{C}$)

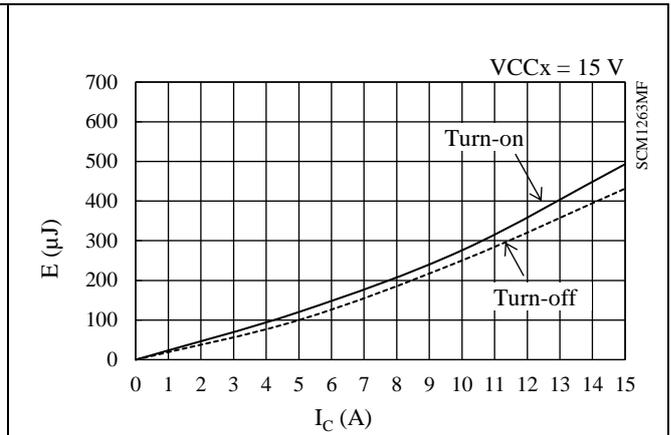


図 15-45 ローサイドスイッチング損失特性
($T_J = 25\text{ }^\circ\text{C}$)

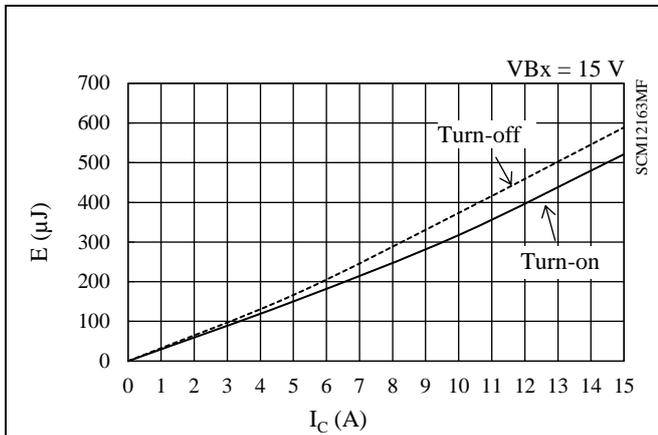


図 15-46 ハイサイドスイッチング損失特性
($T_J = 125\text{ }^\circ\text{C}$)

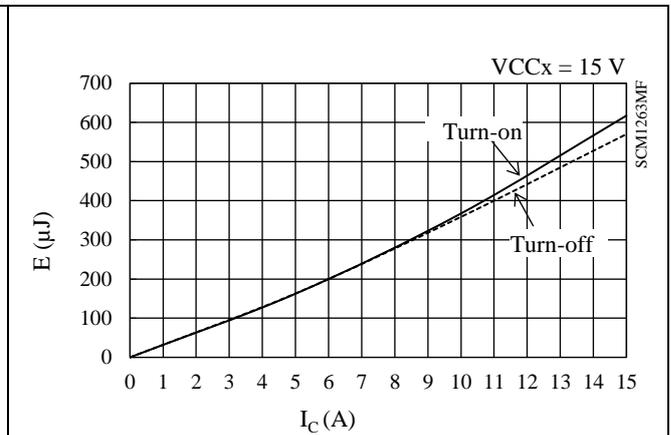


図 15-47 ローサイドスイッチング損失特性
($T_J = 125\text{ }^\circ\text{C}$)

15.3.2.4. SCM1265MF

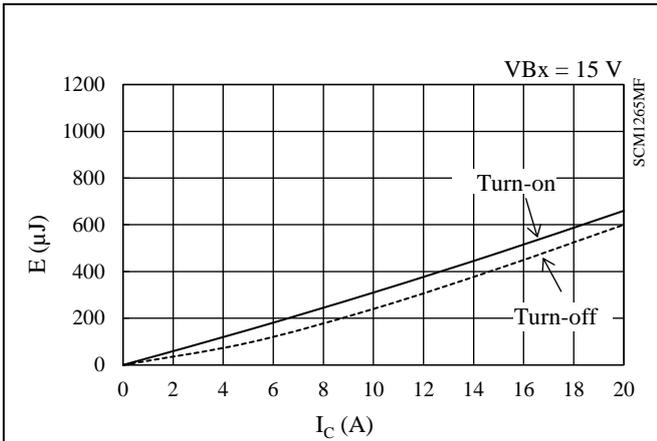


図 15-48 ハイサイドスイッチング損失特性 ($T_J = 25^\circ\text{C}$)

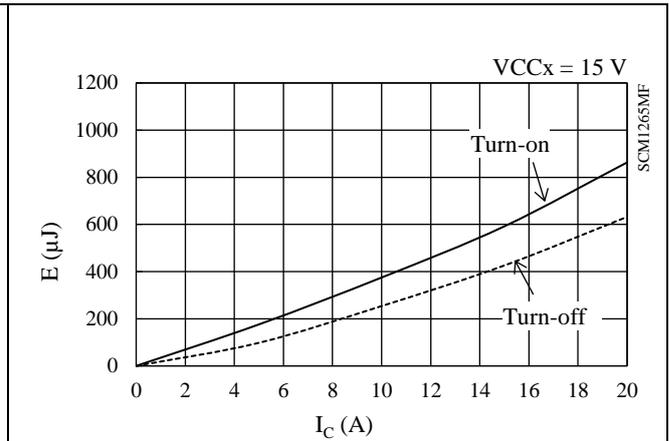


図 15-49 ローサイドスイッチング損失特性 ($T_J = 25^\circ\text{C}$)

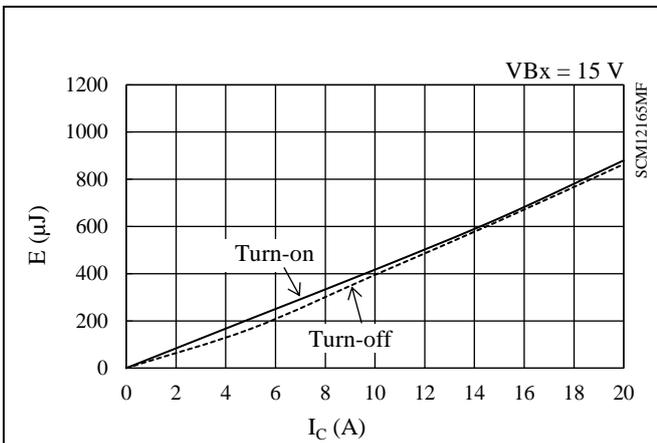


図 15-50 ハイサイドスイッチング損失特性 ($T_J = 125^\circ\text{C}$)

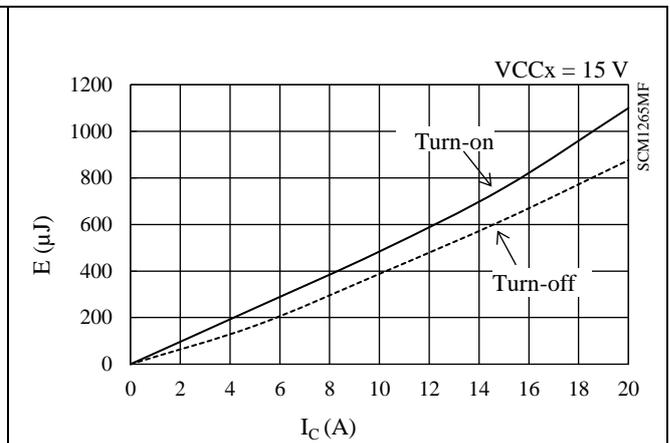


図 15-51 ローサイドスイッチング損失特性 ($T_J = 125^\circ\text{C}$)

15.3.2.5. SCM1256MF

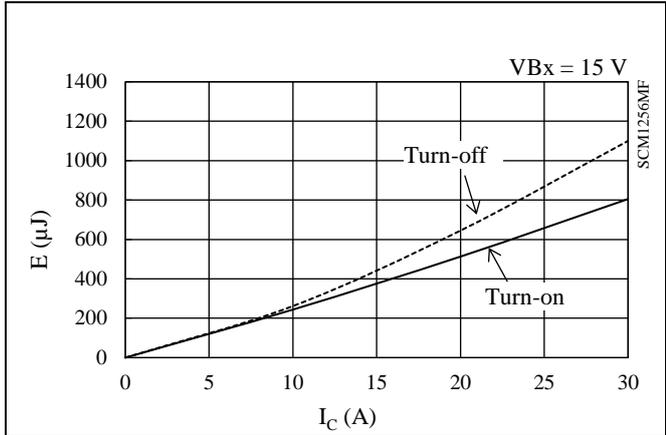


図 15-52 ハイサイドスイッチング損失特性
($T_j = 25\text{ }^\circ\text{C}$)

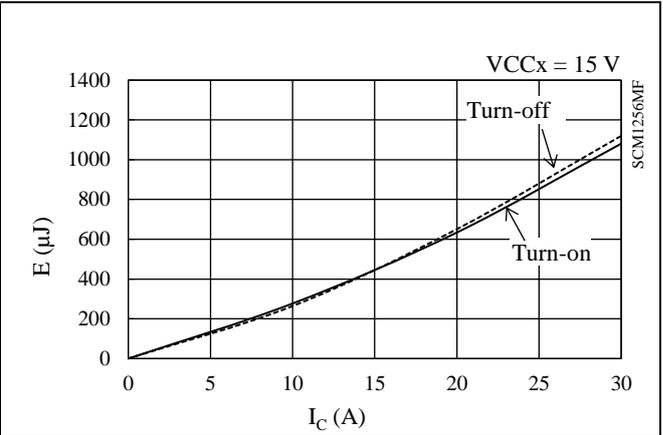


図 15-53 ローサイドスイッチング損失特性
($T_j = 25\text{ }^\circ\text{C}$)

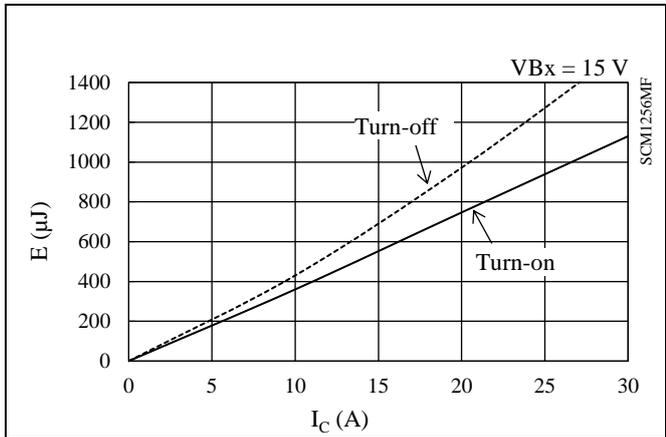


図 15-54 ハイサイドスイッチング損失特性
($T_j = 125\text{ }^\circ\text{C}$)

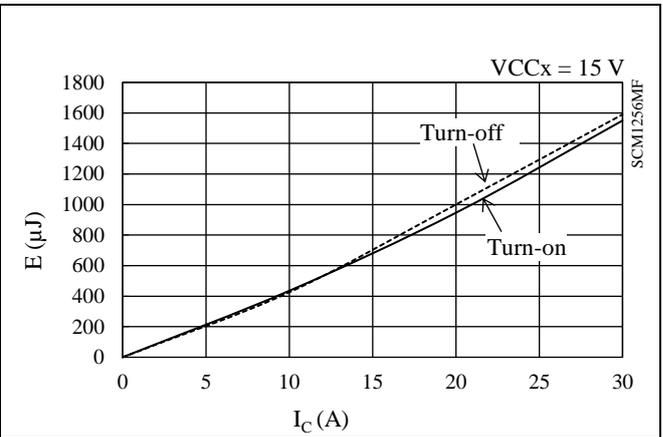


図 15-55 ローサイドスイッチング損失特性
($T_j = 125\text{ }^\circ\text{C}$)

15.4. 許容実効電流特性グラフ

以下に示す許容実効電流特性は、正弦波駆動の3相変調方式、出力素子の $V_{CE(SAT)}$ ($R_{DS(ON)}$) およびスイッチング損失は Typ.品を想定しています。

<動作条件>

VBB 端子入力電圧 $V_{DC} = 300\text{ V}$ 、VCCx 端子入力電圧 $V_{CC} = 15\text{ V}$ 、変調率 $M = 0.9$ 、モータ力率 $\cos\theta = 0.8$ 、ジャンクション温度 $T_J = 150\text{ }^\circ\text{C}$

15.4.1. SCM1261MF

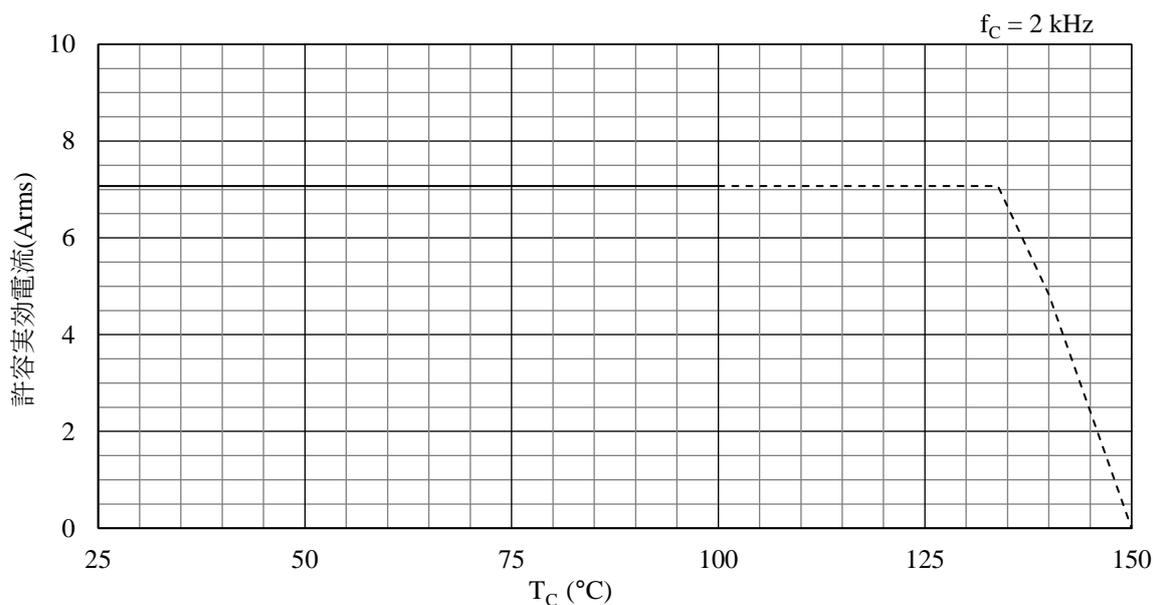


図 15-56 10A 品許容電流特性 ($f_C = 2\text{ kHz}$)

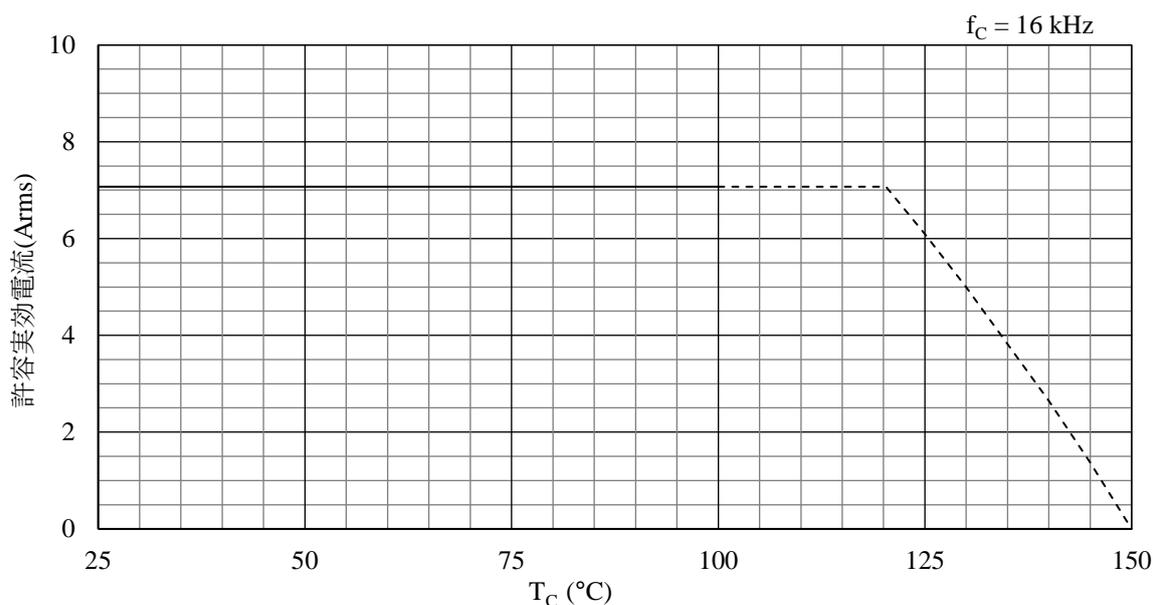


図 15-57 10A 品許容電流特性 ($f_C = 16\text{ kHz}$)

15.4.2. SCM1242MF、SCM1263MF

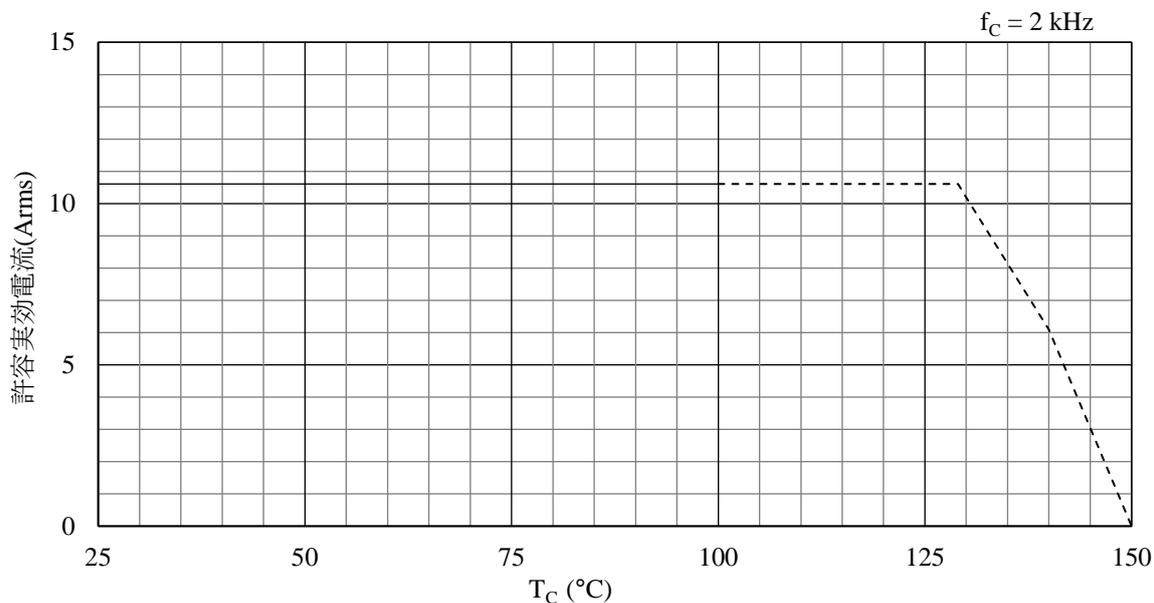


図 15-58 15A 品許容電流特性 ($f_c = 2\text{ kHz}$)

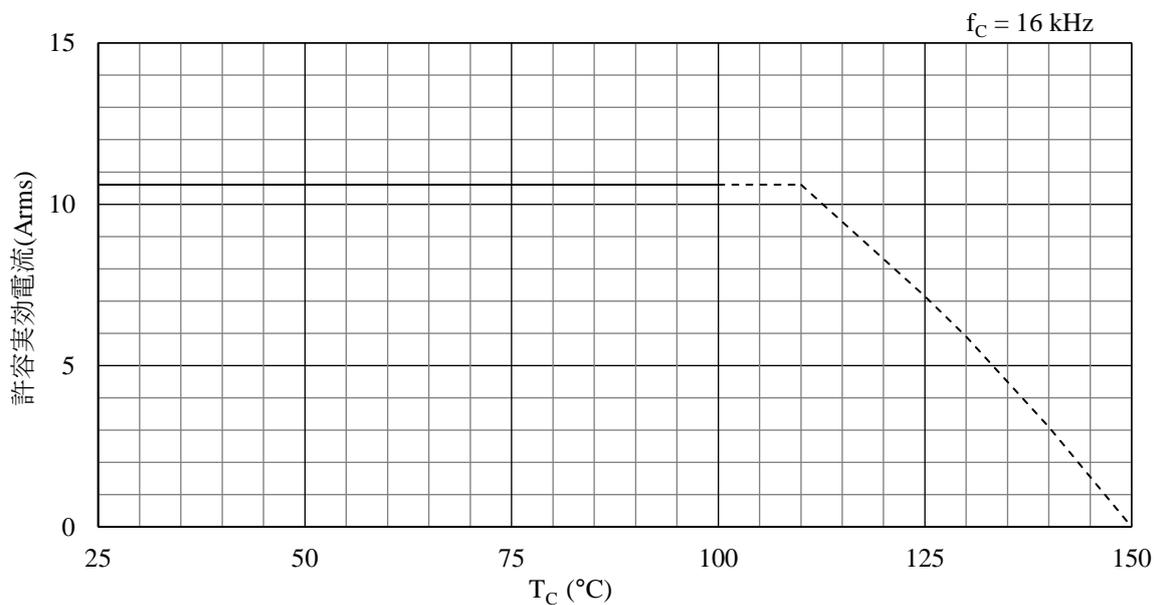


図 15-59 15A 品許容電流特性 ($f_c = 16\text{ kHz}$)

15.4.3. SCM1265MF

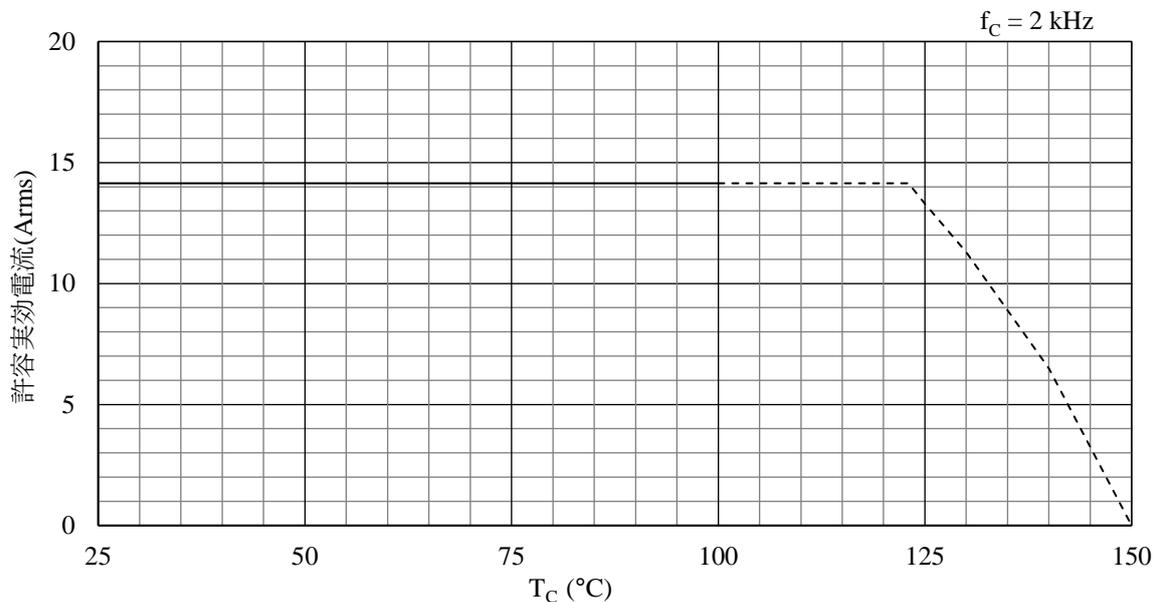


図 15-60 20A 品許容電流特性 ($f_c = 2$ kHz)

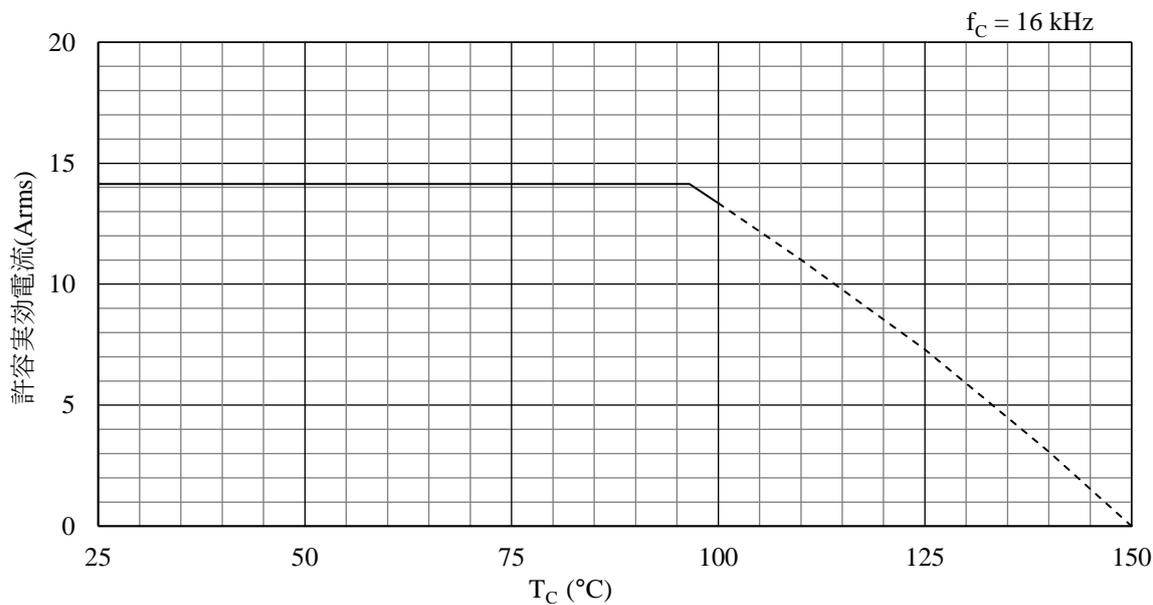


図 15-61 20A 品許容電流特性 ($f_c = 16$ kHz)

15.4.4. SCM1256MF

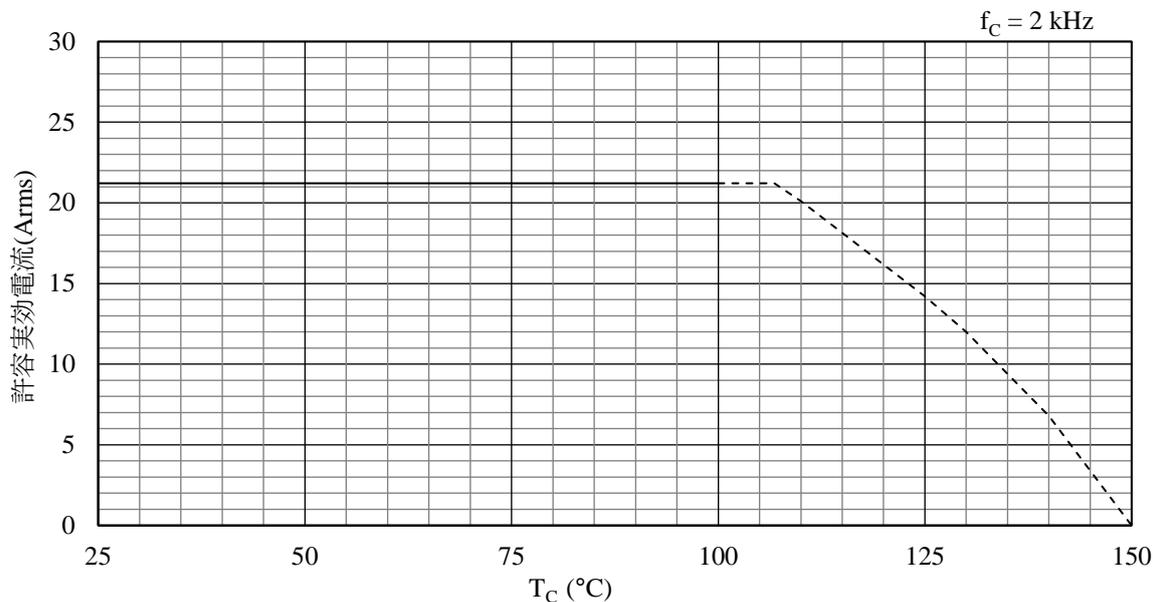


図 15-62 30A 品許容電流特性 ($f_c = 2$ kHz)

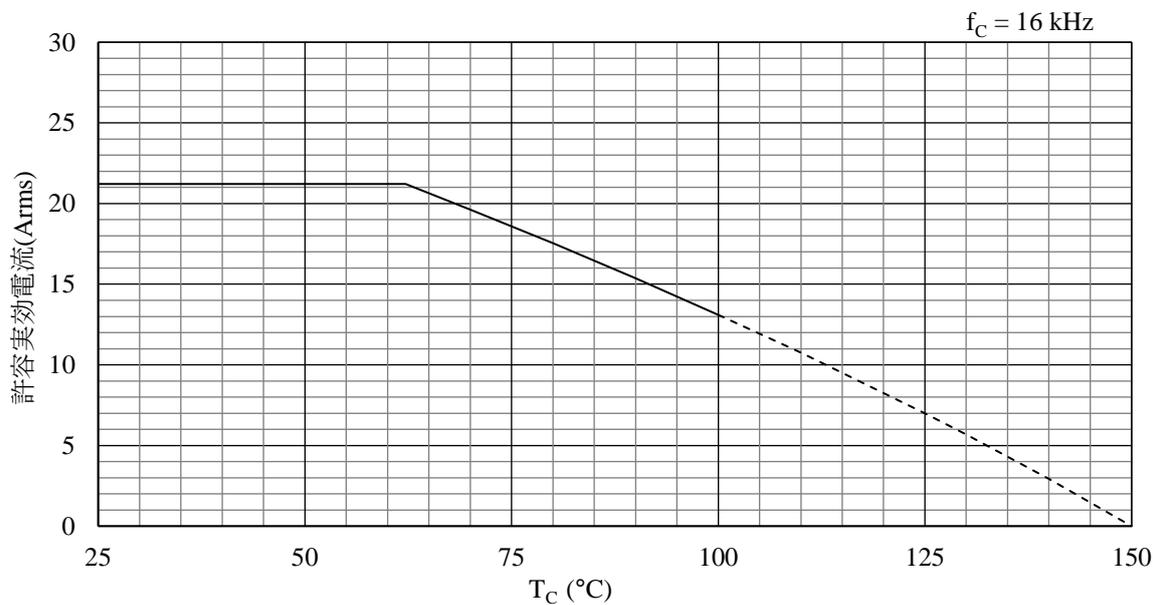
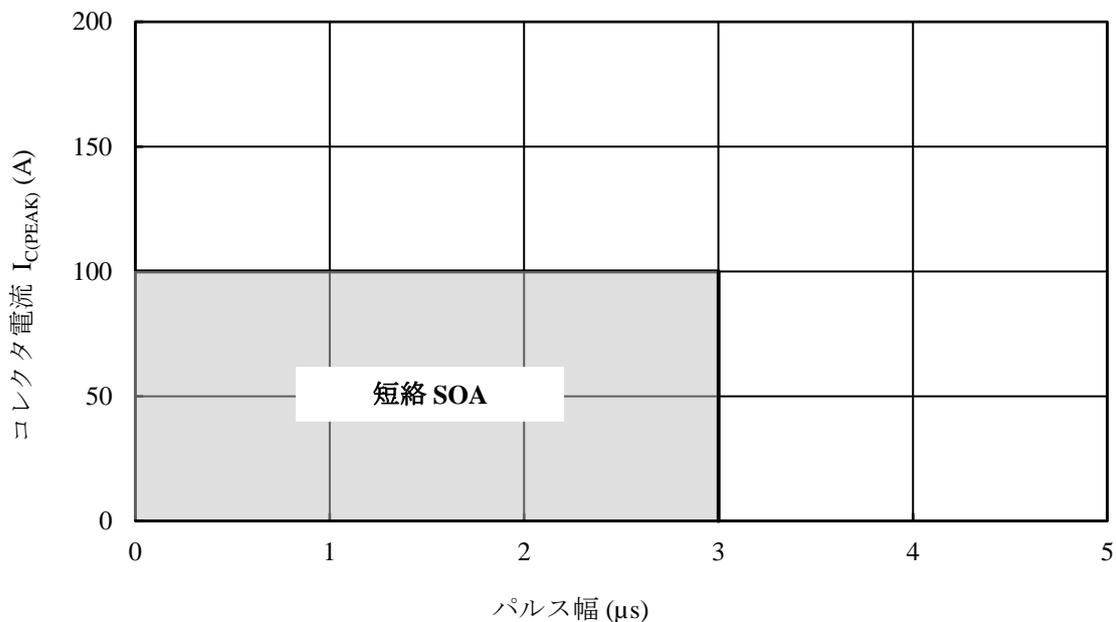


図 15-63 30A 品許容電流特性 ($f_c = 16$ kHz)

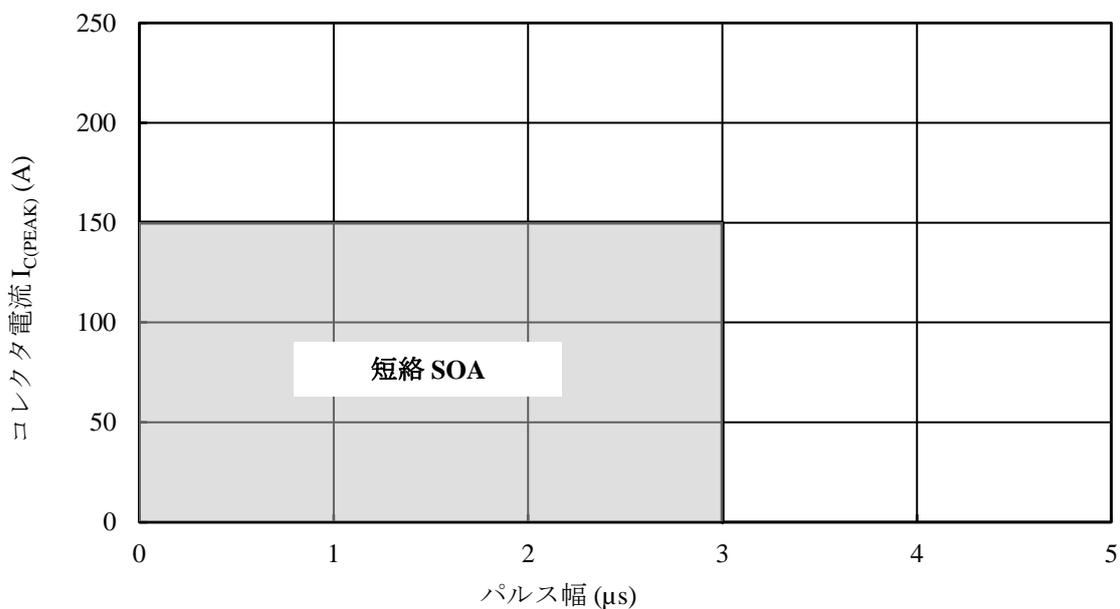
15.5. 短絡 SOA

条件) $V_{DC} \leq 400 \text{ V}$ 、 $13.5 \text{ V} \leq V_{CC} \leq 16.5 \text{ V}$ 、 $T_J = 125 \text{ }^\circ\text{C}$ 、1 パルス

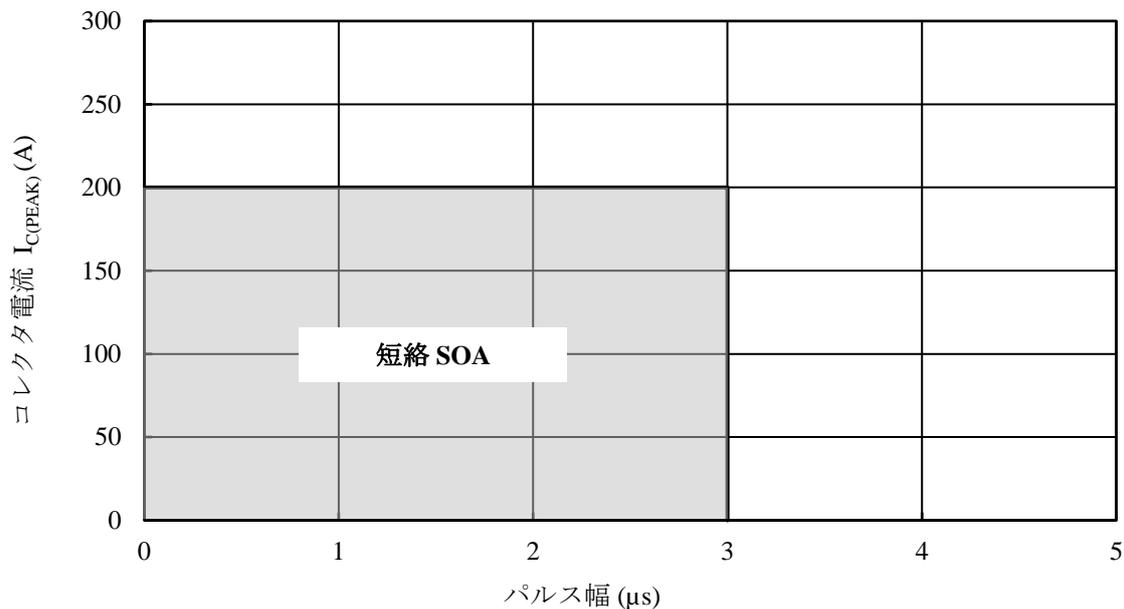
15.5.1. SCM1261MF



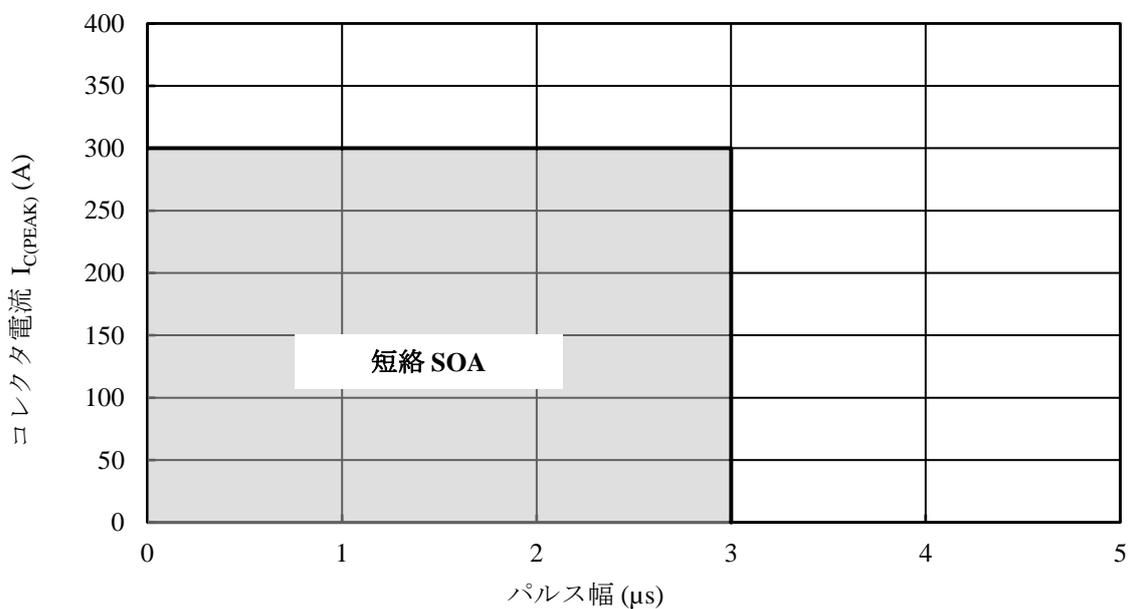
15.5.2. SCM1242MF、SCM1263MF



15.5.3. SCM1265MF



15.5.4. SCM1256MF



16. パターンレイアウト例

以下に、SCM1200MF シリーズを使用したパターンレイアウト例と、その回路図を示します。端子の穴径については 10.3 項を参照してください。

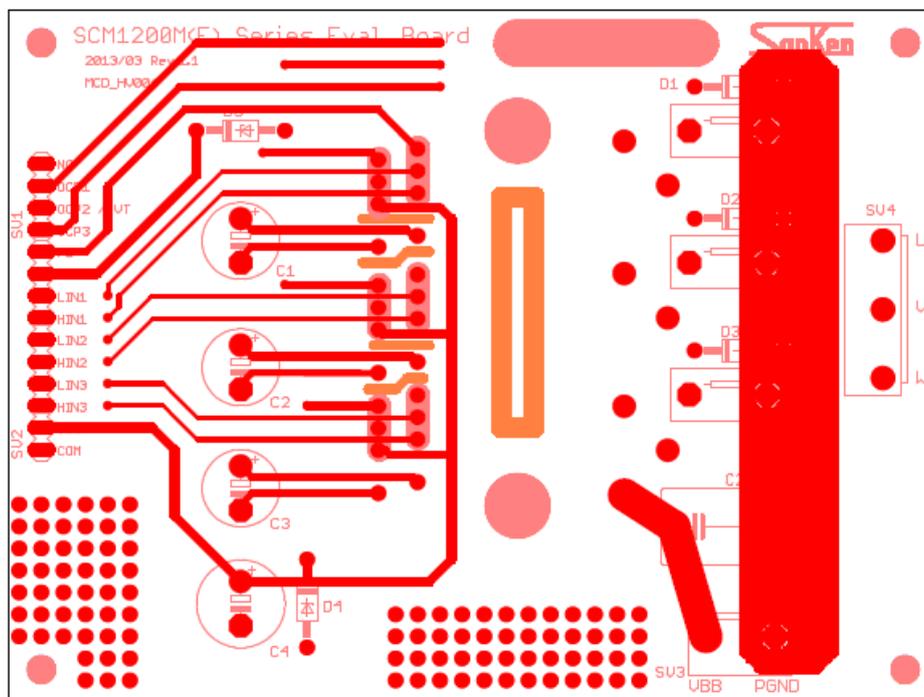


図 16-1 表面パターンレイアウト例

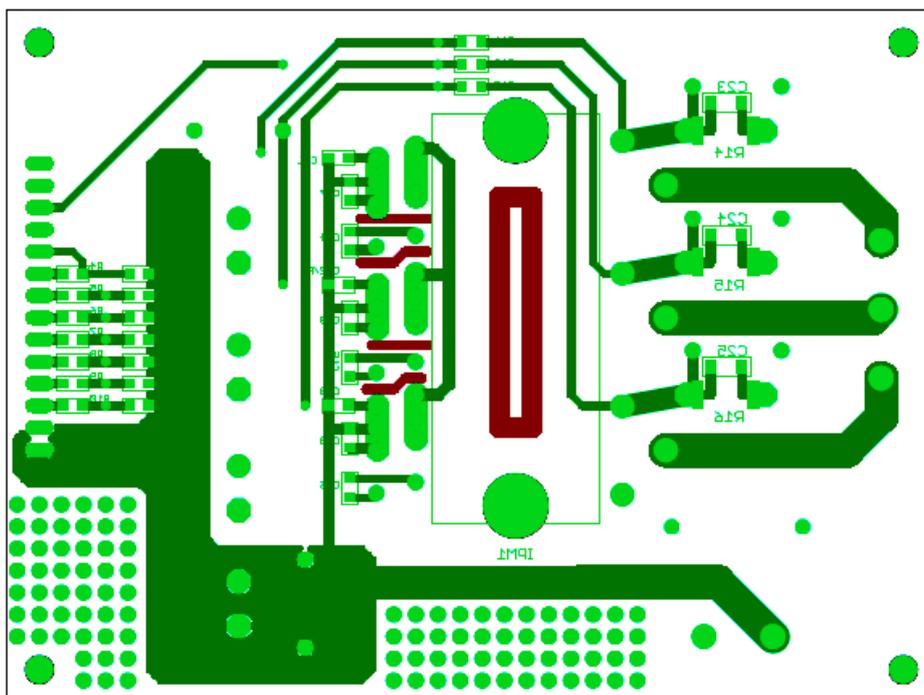


図 16-2 裏面パターンレイアウト例

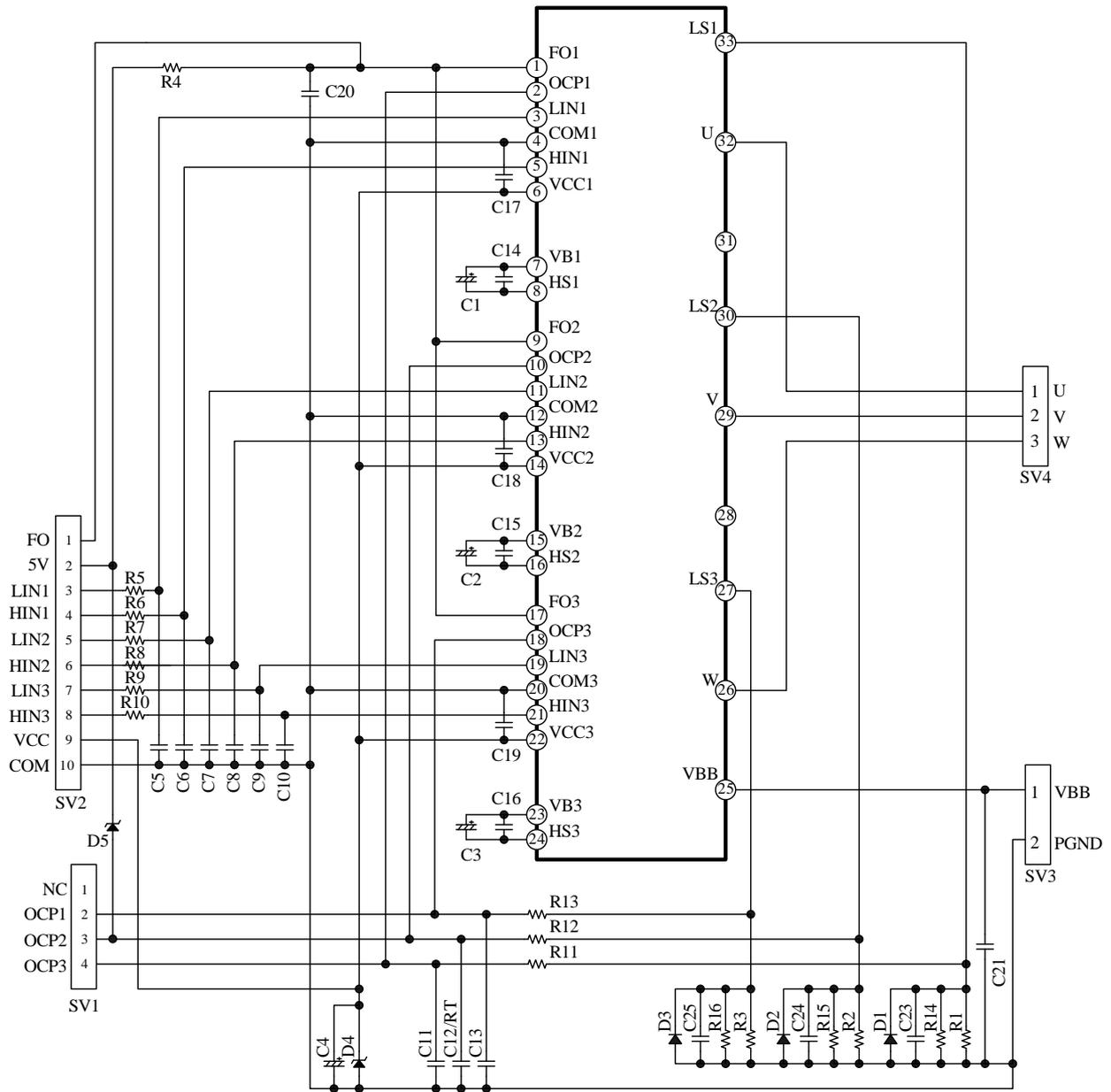


図 16-3 パターンレイアウト回路図

SCM1200MF シリーズ

17. モータドライバ回路例

モータドライバの回路例として、その仕様と回路図および部品表を以下に示します。

- モータドライバ仕様

使用 IC	SCM1242MF
主電源電圧 V_{DC}	DC300V (typ.)
定格出力電力	1.35 kW

- 回路図

図 16-3 参照

- 部品表

記号	部品名	定格	記号	部品名	定格
C1	Electrolytic	47 μ F, 50 V	R1*	Metal plate	27 m Ω , 2 W
C2	Electrolytic	47 μ F, 50 V	R2*	Metal plate	27 m Ω , 2 W
C3	Electrolytic	47 μ F, 50 V	R3*	Metal plate	27 m Ω , 2 W
C4	Electrolytic	100 μ F, 50 V	R4	General	4.7 k Ω , 1/8 W
C5	Ceramic	100 pF, 50 V	R5	General	100 Ω , 1/8 W
C6	Ceramic	100 pF, 50 V	R6	General	100 Ω , 1/8 W
C7	Ceramic	100 pF, 50 V	R7	General	100 Ω , 1/8 W
C8	Ceramic	100 pF, 50 V	R8	General	100 Ω , 1/8 W
C9	Ceramic	100 pF, 50 V	R9	General	100 Ω , 1/8 W
C10	Ceramic	100 pF, 50 V	R10	General	100 Ω , 1/8 W
C11	Ceramic	2200 pF, 50 V	R11	General	100 Ω , 1/8 W
C12/RT	Ceramic	2200 pF, 50 V	R12	General	100 Ω , 1/8 W
C13	Ceramic	2200 pF, 50 V	R13	General	100 Ω , 1/8 W
C14	Ceramic	0.1 μ F, 50 V	R14*	General	Open
C15	Ceramic	0.1 μ F, 50 V	R15*	General	Open
C16	Ceramic	0.1 μ F, 50 V	R16*	General	Open
C17	Ceramic	0.1 μ F, 50 V	D1	General	1 A, 50 V
C18	Ceramic	0.1 μ F, 50 V	D2	General	1 A, 50 V
C19	Ceramic	0.1 μ F, 50 V	D3	General	1 A, 50 V
C20	Ceramic	0.01 μ F, 50 V	D4	Zener	$V_Z = 20$ V, 0.5 W
C21	Film	0.1 μ F, 630 V	D5	General	Open
C22*	Ceramic	0.1 μ F, 50 V	SV1	Pin header	MA04-1 相当
C23*	Ceramic	0.1 μ F, 50 V	SV2	Pin header	MA10-1 相当
C24*	Ceramic	0.1 μ F, 50 V	SV3	Connector	B2P3-VH 相当
C25	Ceramic	Open	SV4	Connector	B3P5-VH 相当
			IPM1	IC	SCM1242MF

* 実機評価で調整が必要な部品

注意書き

- 本書に記載している製品（以下、「本製品」という）のデータ、図、表、およびその他の情報（以下、「本情報」という）は、本書発行時点のものであります。本情報は、改良などで予告なく変更することがあります。本製品を使用する際は、本情報が最新であることを弊社販売窓口を確認してください。
- 本製品は、一般電子機器（家電製品、事務機器、通信端末機器、計測機器など）の部品に使用されることを意図しております。本製品を使用する際は、納入仕様書に署名または記名押印のうえ、返却をお願いします。高い信頼性が要求される装置（輸送機器とその制御装置、交通信号制御装置、防災装置、防犯装置、各種安全装置など）に本製品を使用することを検討する際は、必ず事前にその使用の適否について弊社販売窓口へ相談いただき、納入仕様書に署名または記名押印のうえ、返却をお願いします。本製品は、極めて高い信頼性が要求される機器または装置（航空宇宙機器、原子力制御、その故障や誤動作が生命や人体に危害を及ぼす恐れのある医療機器（日本における法令でクラスⅢ以上）など）（以下「特定用途」という）に使用されることは意図されておられません。特定用途に本製品を使用したことでお客様または第三者に生じた損害などに関して、弊社は一切その責任を負いません。
- 本製品を使用するにあたり、本製品に他の製品や部材を組み合わせる際、あるいはこれらの製品に物理的、化学的、その他の何らかの加工や処理を施す際は、使用者の責任においてそのリスクを必ず検討したうえで行ってください。
- 弊社は、品質や信頼性の向上に努めていますが、半導体製品は、ある確率で欠陥や故障が発生することは避けられません。本製品が故障し、その結果として人身事故、火災事故、社会的な損害などが発生しないように、故障発生率やディレーティングなどを考慮したうえで、使用者の責任において、本製品が使用される装置やシステム上で、十分な安全設計および確認を含む予防措置を必ず行ってください。ディレーティングについては、納入仕様書および弊社ホームページを参照してください。
- 本製品は、耐放射線設計をしておりません。
- 本書に記載している回路定数、動作例、回路例、パターンレイアウト例、設計例、推奨例、本書に記載しているすべての情報、およびこれらに基づく評価結果などは、使用上の参考として示したものです。
- 本情報に起因する使用者または第三者のいかなる損害、および使用者または第三者の知的財産権を含む財産権とその他一切の権利の侵害問題について、弊社は一切その責任を負いません。
- 本情報を、文書による弊社の承諾なしに転記や複製することを禁じます。
- 本情報について、弊社の所有する知的財産権およびその他の権利の実施、使用または利用を許諾するものではありません。
- 使用者と弊社との間で別途文書による合意がない限り、弊社は、本製品の品質（商品性、および特定目的または特別環境に対する適合性を含む）ならびに本情報（正確性、有用性、および信頼性を含む）について、明示的か黙示的かを問わず、いかなる保証もしておりません。
- 本製品を使用する際は、特定の物質の含有や使用を規制する RoHS 指令など、適用される可能性がある環境関連法令を十分に調査したうえで、当該法令に適合するように使用してください。
- 本製品および本情報を、大量破壊兵器の開発を含む軍事用途やその他軍事利用の目的で使用しないでください。また、本製品および本情報を輸出または非居住者などに提供する際は、「米国輸出管理規則」や「外国為替及び外国貿易法」など、各国で適用される輸出管理法令などを遵守してください。
- 弊社物流網以外における本製品の落下などの輸送中のトラブルについて、弊社は一切その責任を負いません。
- 本書は、正確を期すために慎重に製作したのですが、本書に誤りがないことを保証するものではありません。万一、本情報の誤りや欠落に起因して、使用者に損害が生じた場合においても、弊社は一切その責任を負いません。
- 本製品を使用する際の一般的な使用上の注意は弊社ホームページを、特に注意する内容は納入仕様書を参照してください。
- 本書で使用されている個々の商標、商号に関する権利は、弊社を含むその他の原権利者に帰属します。